

Cours 9

Reponse en frequences
et miroirs de courant en CMOS

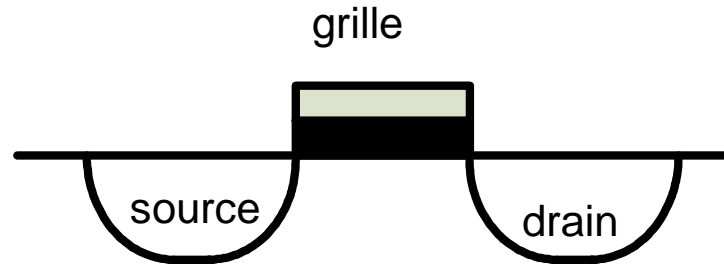
Analyse haute frequence

- Avec BJT:
 - Modele Physique
 - Analyse DC
 - Modele petit signal
 - Modele petit signal a haute frequence
- Avec CMOS, on est passe par les 3 premieres etapes
- On a un modele qui semble operer a n'importe quelle vitesse: impossible

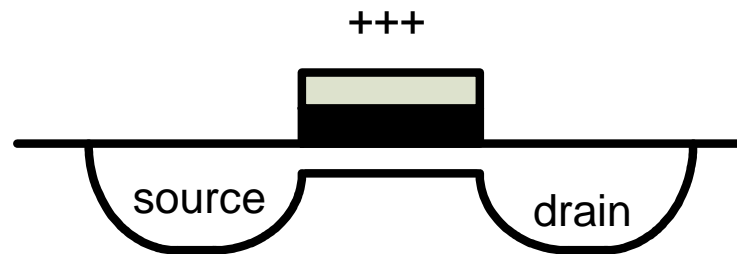
Il faut completer le modele

Analyse haute frequence

- Un transistor CMOS ressemble a ca:

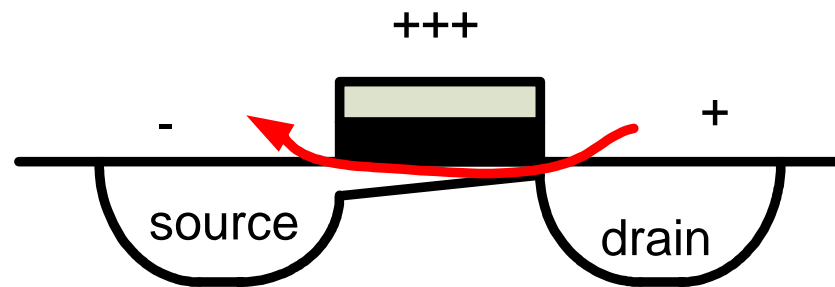


- En appliquant une tension a la grille, on forme un canal...

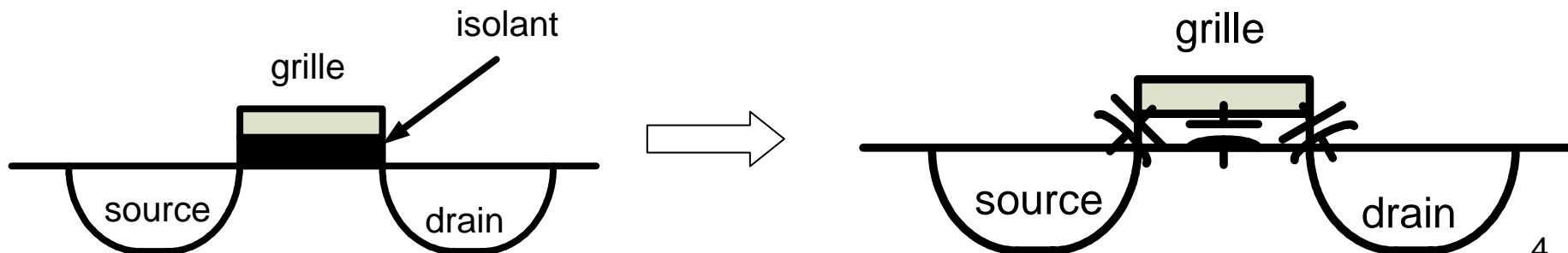


Analyse haute frequence

- En appliquant V_{DS} , on a un courant I_D :

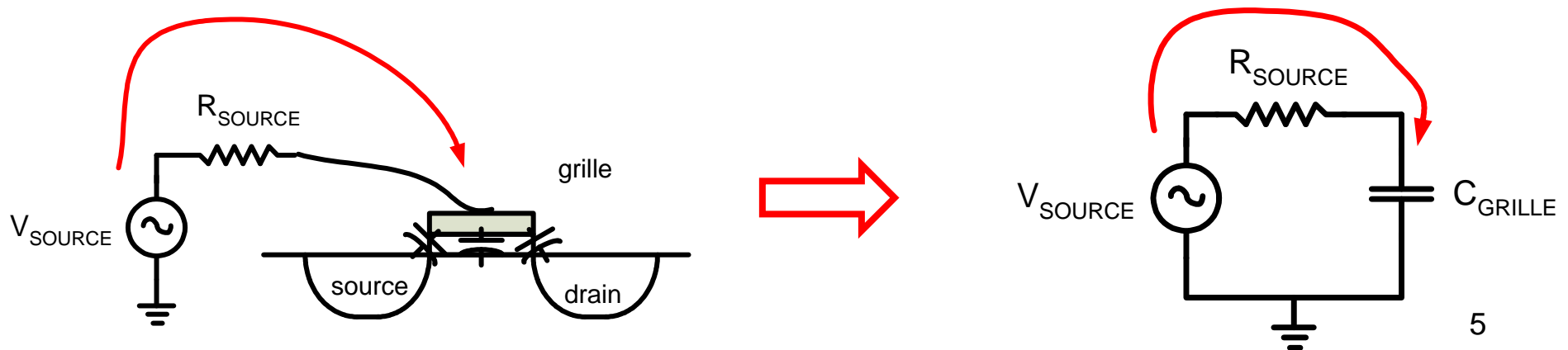


- Qu'est-ce qu'on a negligé dans le modele?
 - Conducteur-isolant-conducteur: Capacite



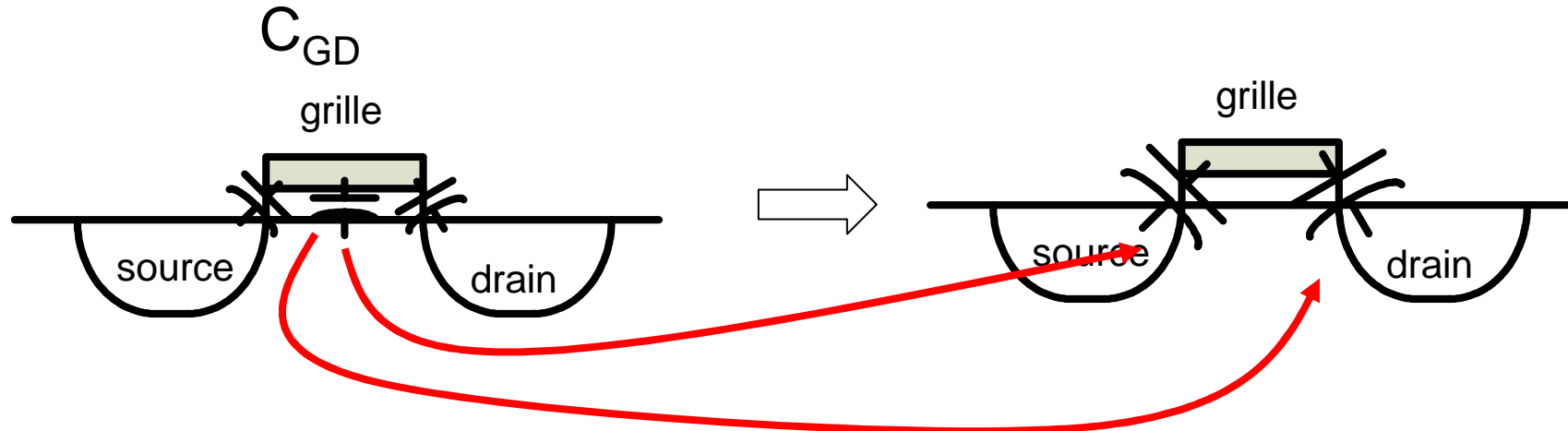
Analyse haute frequence

- Condensateurs “parasites” entre la grille et source, drain et canal
- Pour creer un canal, il faut $V_{GS} > 0.7$
 - Ca va prendre du temps pour charger les capacites
 - Ca va prendre du temps pour changer V_{GS}



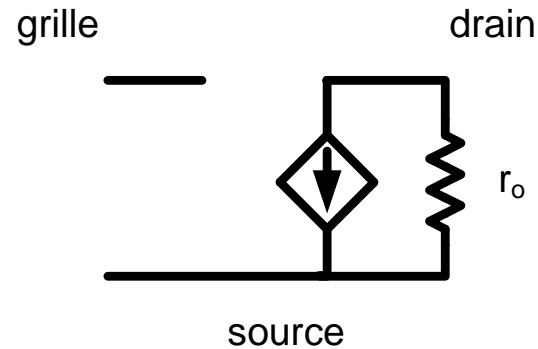
Analyse haute frequence

- Il faut en tenir compte dans le modele
 - Capacite grille-source: C_{GS}
 - Capacite grille-drain: C_{GD}
 - Capacite grille-canal
- Probleme mineur: Pas de noeud au canal
 - On va diviser ce C en 2 et regrouper dans C_{GS} et

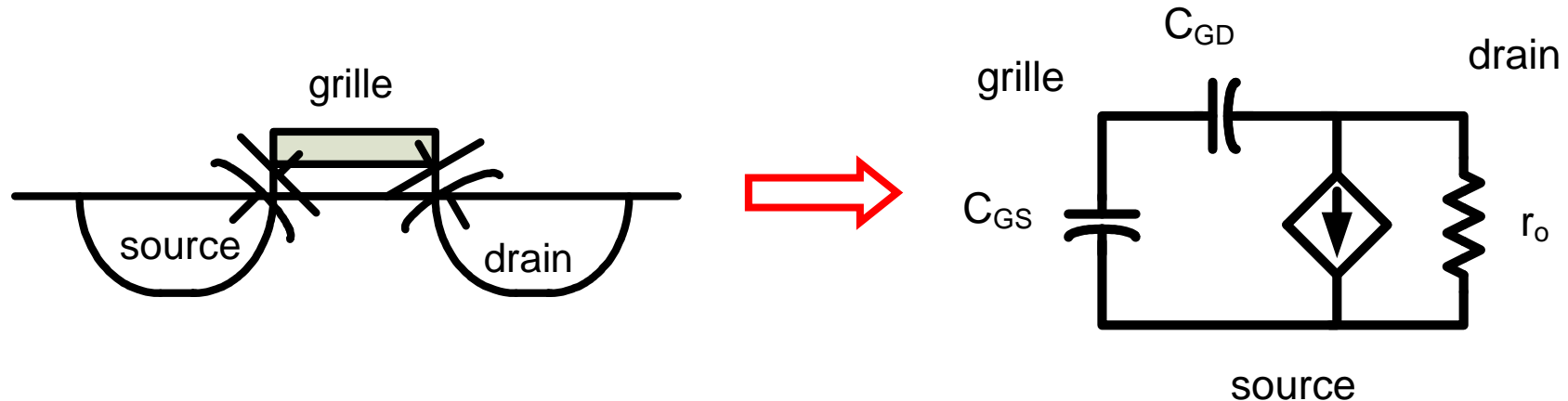


Analyse haute frequence

- Le modele petit signal en π etait:



- En hautes frequences, ce modele devient :



Analyse haute frequence

- Les transistors ne peuvent pas fonctionner a vitesse infinie:
 - C_{GS} et C_{GD} vont nous aider a determiner la frequence maximale
- Pour trouver frequence maximale, on peut utiliser la facon classique:
 - Transformee de Laplace
 - Substituer s par $j\omega$
 - Mettre egal a -3dB et trouver ω_{-3dB} .

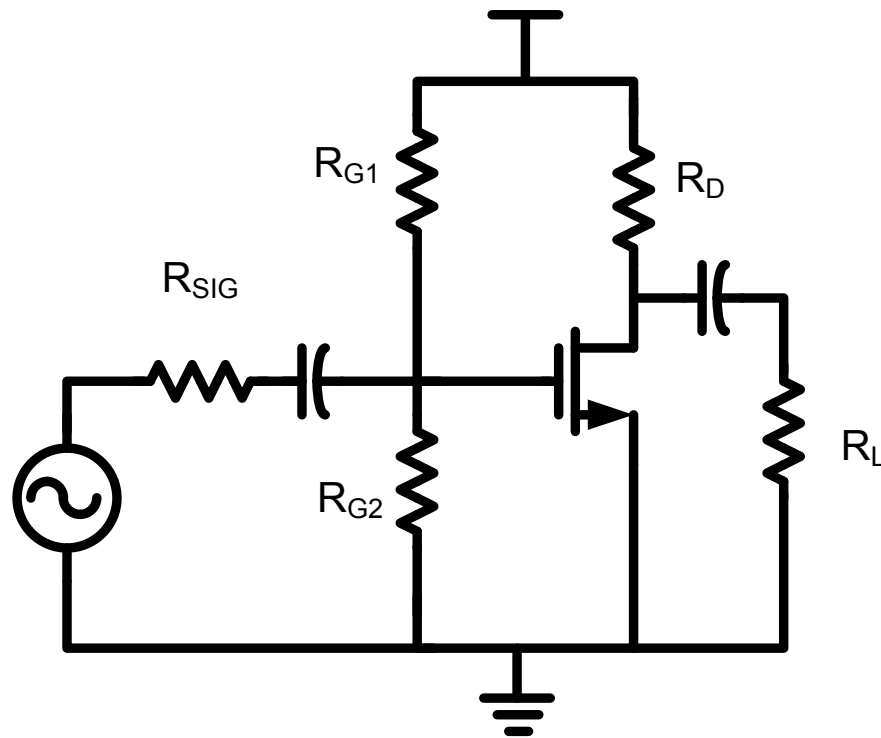
Sinon, on connait une autre facon de faire...

Analyse haute frequence

- On a vu l'analyse par constante de temps
 - Plus rapide
 - Indique la contribution de chaque element
 - "Probleme": manque de precision
- On utilise les constantes de temps pour explorer les 3 configurations classiques:
 - Source Commune
 - Grille Commune
 - Drain Commun

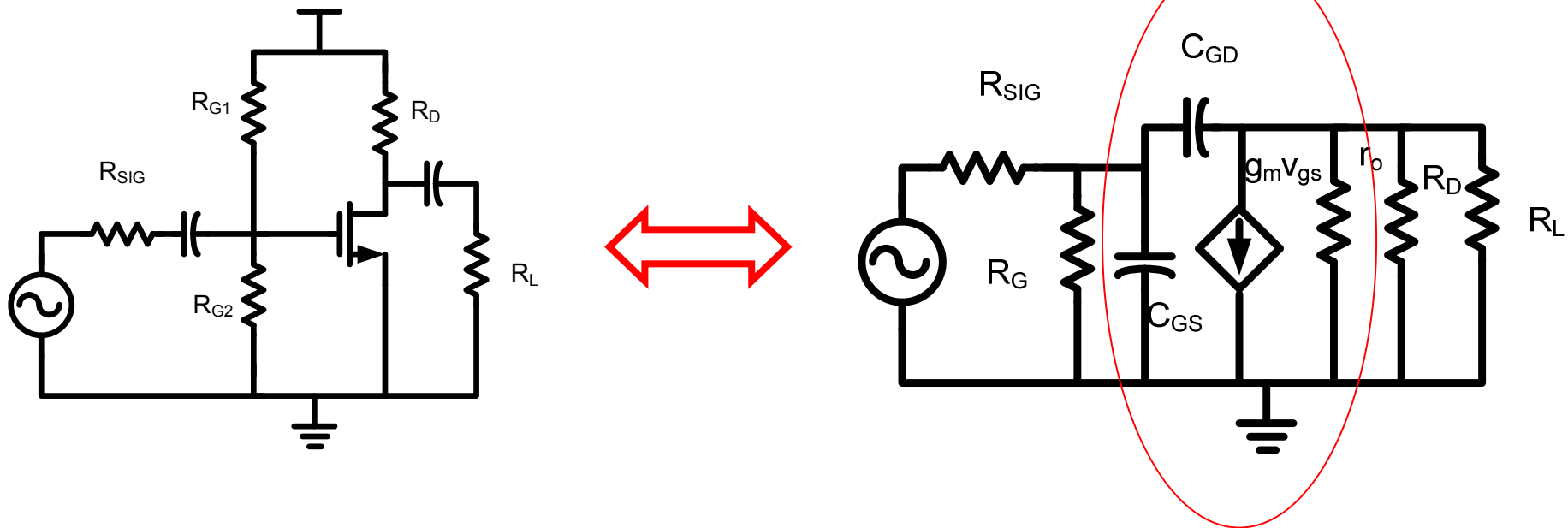
Source commune

- La source commune ressemble a ca:



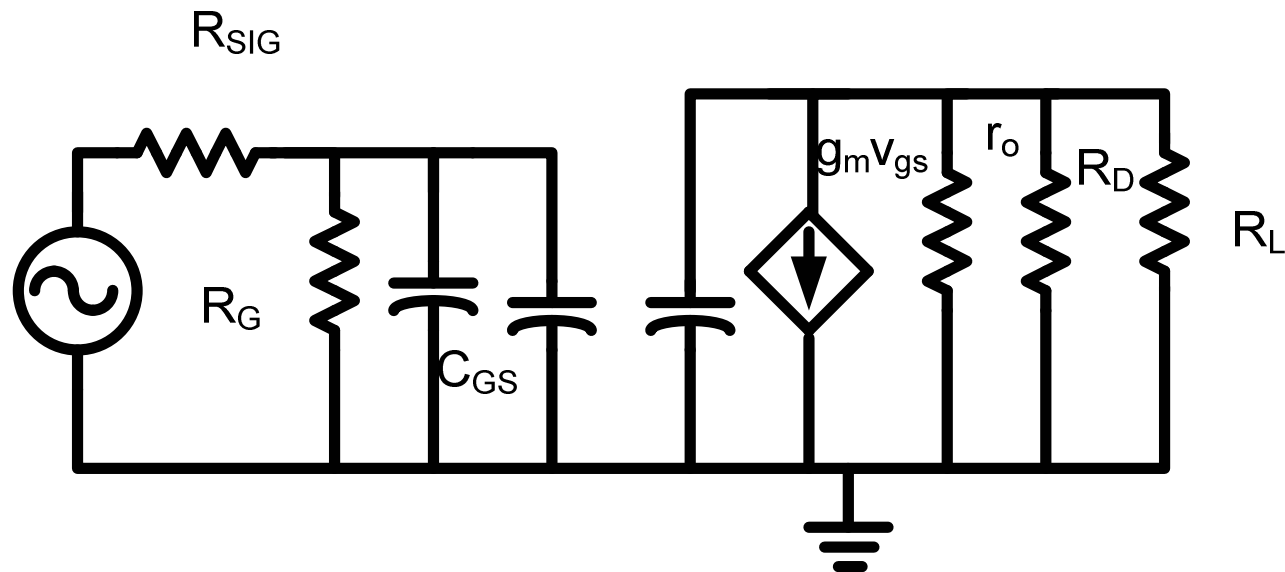
Source commune

- On peut convertir le tout en modele petit signal



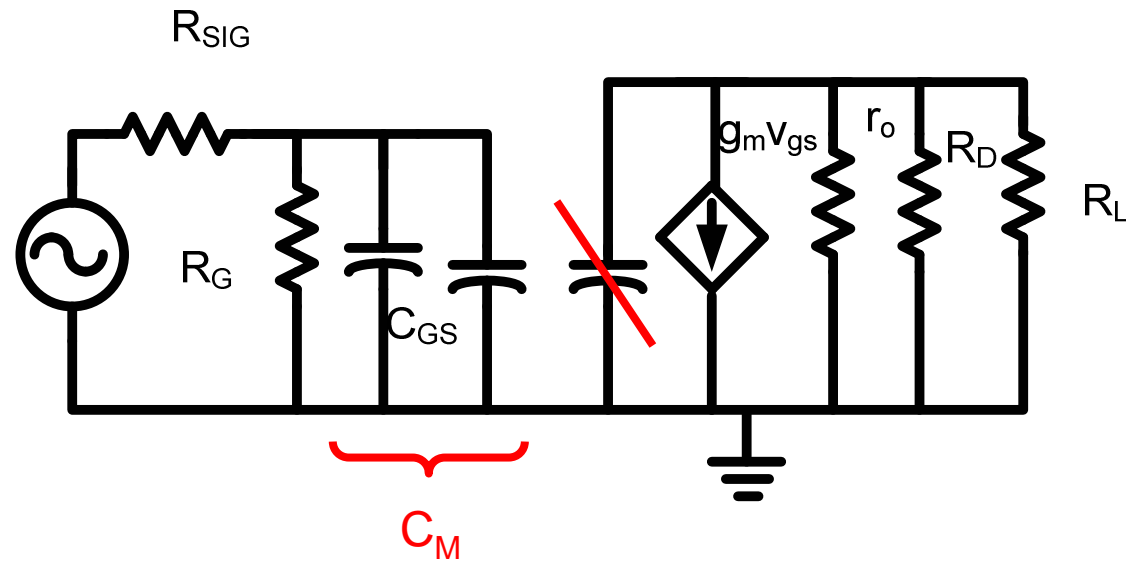
Source commune

- En se rappelant du theoreme de Miller, on peut faire une transformation du circuit



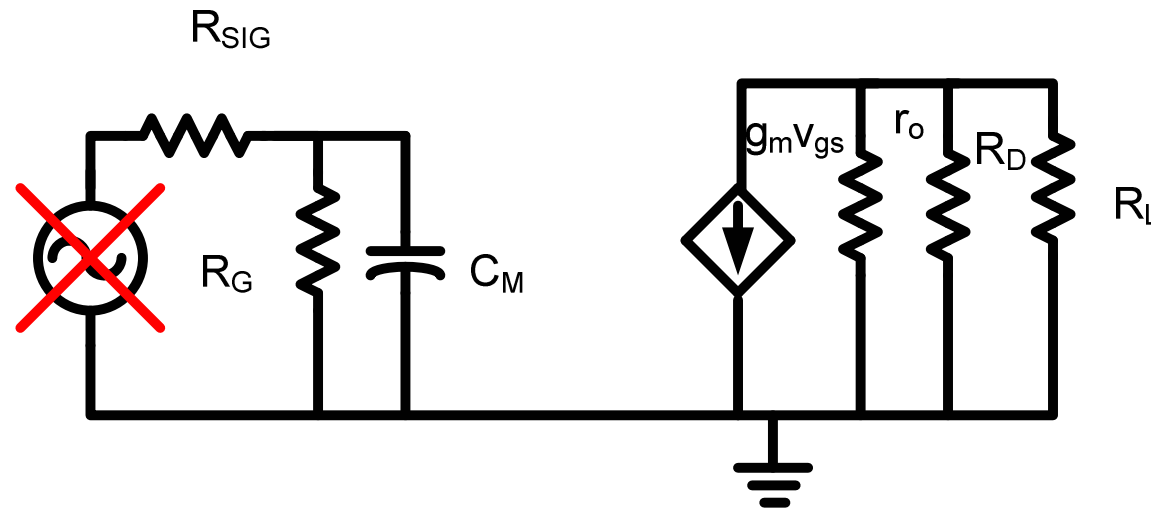
Source commune

- Capacité de Miller est principalement due à l'entrée. On ignore la capacité de sortie.
- On combine les 2 C à l'entrée: C_M



Source commune

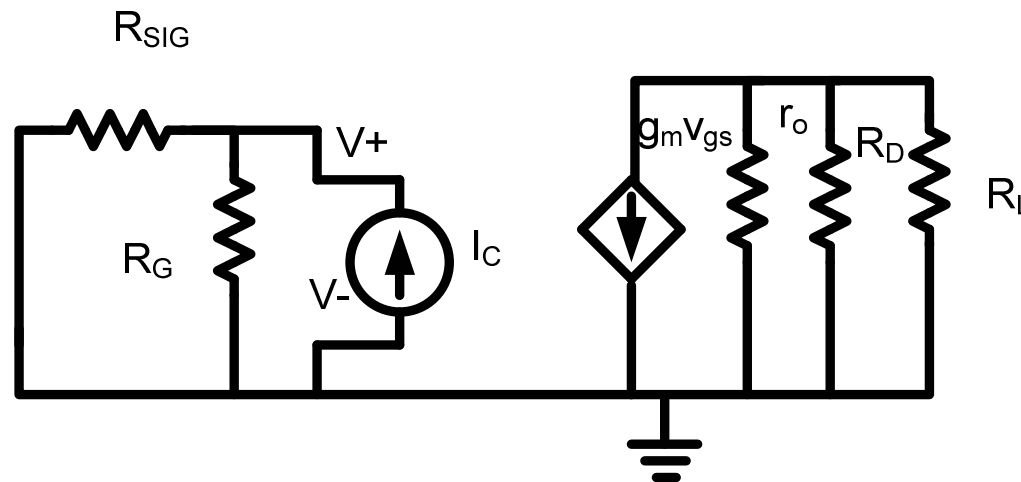
- Constante de temps circuit ouvert
 - On tue les sources INDEPENDANTES
 - On considere 1 C a la fois
 - Quel R voit-on a partir de ce C?



Oui, c'est $R_{SIG} \parallel R_G$, mais on va prendre notre temps...

Source commune

- Pour déterminer R_{EQ} :
 - On change le C en source de courant
 - On trouve V_+
 - On trouve V_-
 - $V_+ - V_- / I_C = R_{EQ}$



$$V_+ = I_C (R_{SIG} \parallel R_G)$$

$$V_- = 0$$

Source commune

- On trouve la resistance equivalente:

$$\begin{array}{l} V_+ = I_C (R_{SIG} \parallel R_G) \\ V_- = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad R_{EQ} = \frac{V_+ - V_-}{I_C} = (R_{SIG} \parallel R_G)$$

- On peut trouver la constante de temps:

$$\tau = C_M R_{EQ} = C_M (R_{SIG} \parallel R_G)$$

- C_M c'est C_{GS} et la capacite de miller

- Capacite de Miller: $(1-A)C_{GD}$
- Le gain est egal a $-g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_o)$
- Capacite de Miller: $[1 + g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_o)] C_{GD}$

Source commune

- Donc, C_M est:

$$C_M = C_{GS} + C_{GD} (1 + g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L))$$

- On substitue dans l'équation de τ :

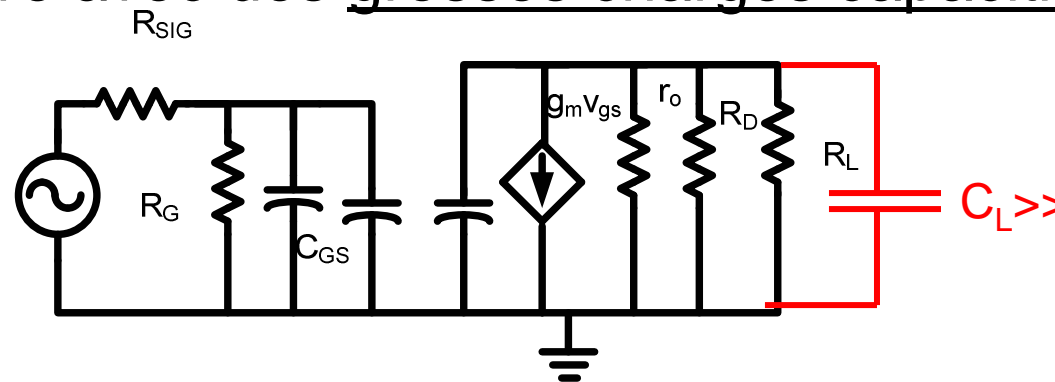
$$\tau = \underline{[C_{GS} + C_{GD} (1 + g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L))]} (R_{SIG} \parallel R_G)$$

- La fréquence -3dB est l'inverse de τ :

$$\omega_{-3dB} = \frac{1}{[C_{GS} + C_{GD} (1 + g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L))]} (R_{SIG} \parallel R_G)$$

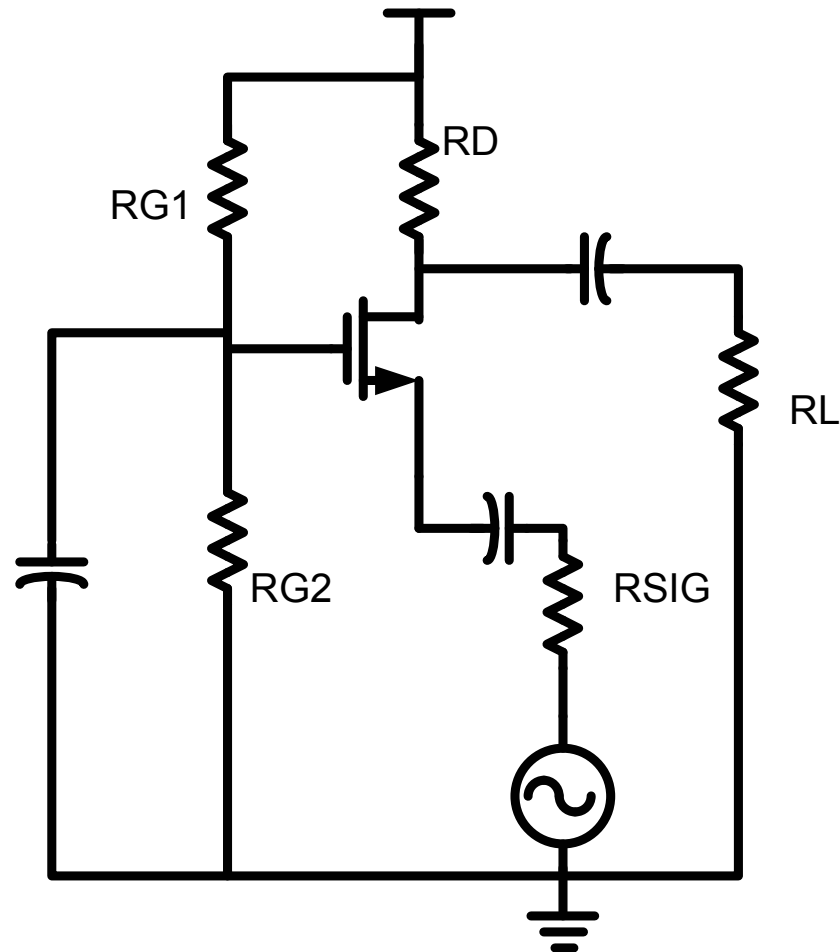
Source commune: discussion

- L'effet de Miller affecte l'entrée.
 - Gros impact: Capacité multipliée.
 - Résistance de la source détermine la fréquence de coupure.
- Si R_{SOURCE} était faible, la sortie pourrait déterminer la fréquence de coupure
 - Arrive avec des grosses charges capacitives...



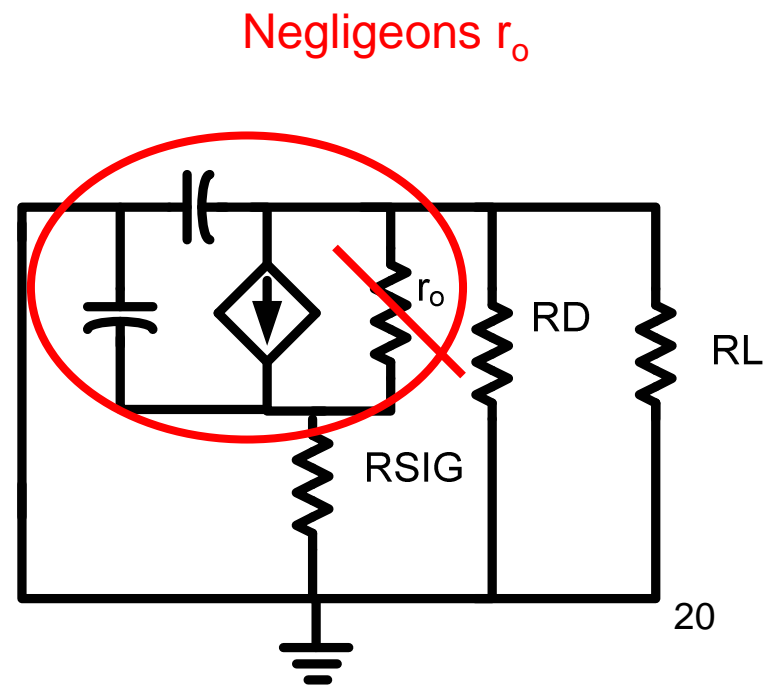
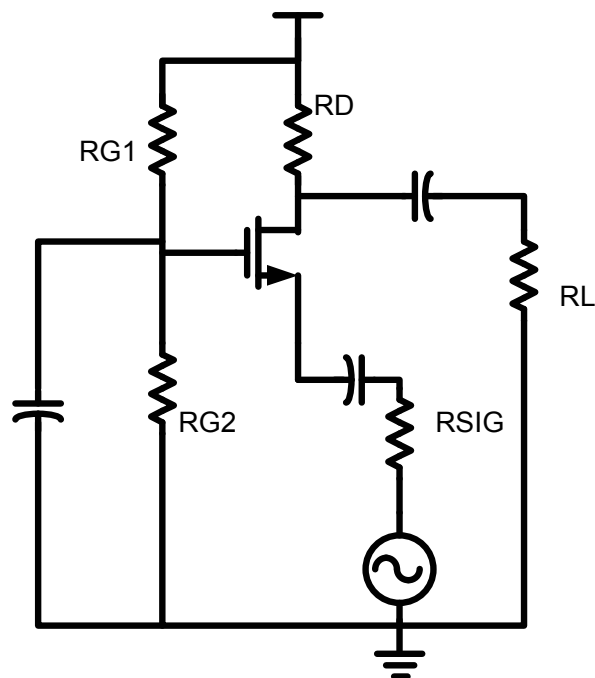
Grille commune

- La grille commune ressemble a ca:



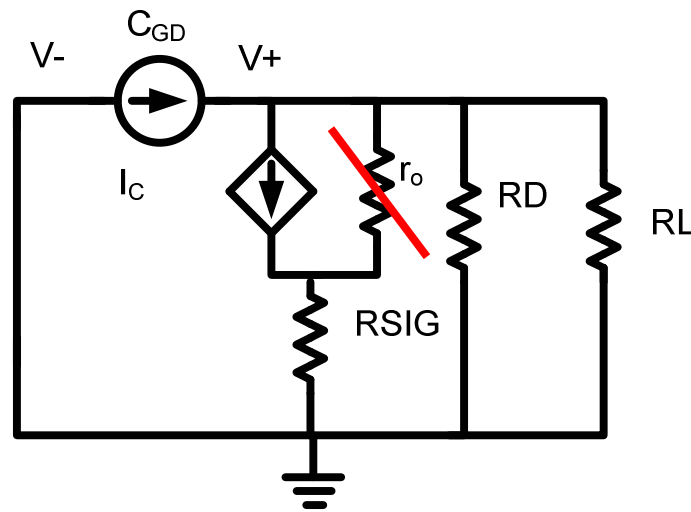
Grille commune

- On fait l'analyse AC:
 - On substitue le transistor par le modele petit signal
 - On met les sources independantes a 0...



Grille commune

- Prenons C_{GD} et trouvons le τ .
 - On considère 1 C et les autres sont circuits ouverts
 - On remplace notre C par une source de courant
 - On calcule V_+
 - On calcule V_-
 - $R_{EQ} = (V_+ - V_-) / I_C$
 - $\tau = CR_{EQ}$



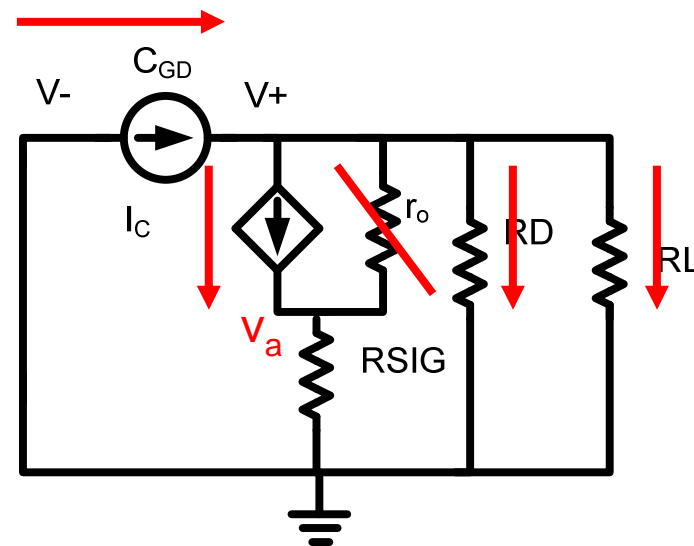
Grille commune

- On écrit l'équation du courant

$$I_C = g_m v_{gs} + \frac{v_+}{(R_D \parallel R_L)}$$

- On sait que v_{gs} c'est $0 - v_a$

$$I_C = -g_m v_a + \frac{v_+}{(R_D \parallel R_L)}$$



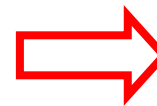
Grille commune

- On écrit l'équation du courant

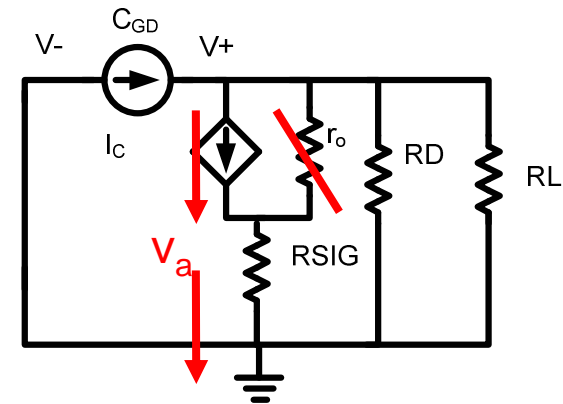
$$-g_m v_a = \frac{v_a}{R_{SIG}}$$

- On peut re-écrire ça:

$$\frac{v_a}{R_{SIG}} + g_m v_a = 0$$



$$v_a = 0$$



- Notre 1re equation devient:

$$I_C = \frac{v_+}{(R_D \parallel R_L)}$$

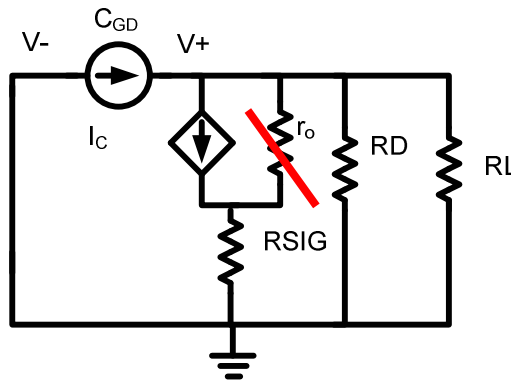
Grille commune

- Avec $V_- = 0$, on trouve R_{EQ} :

$$R_{EQ} = \frac{v_+}{I_C} = (R_D \parallel R_L)$$

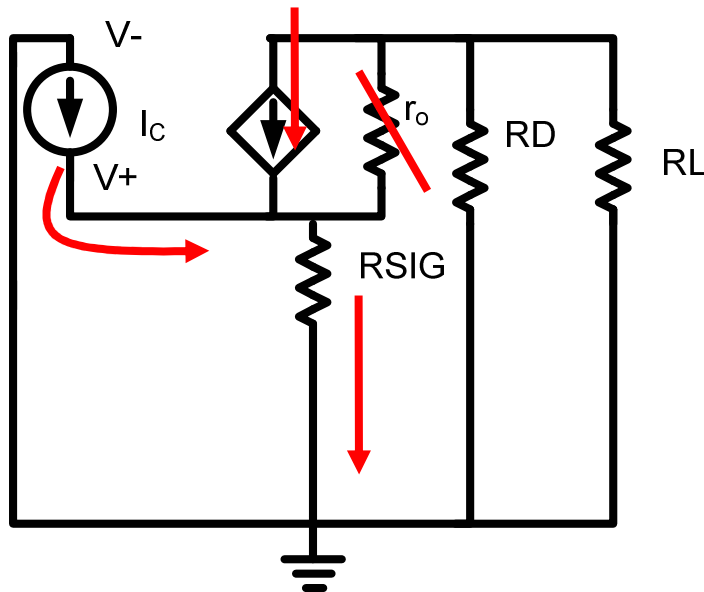
- La constante de temps pour C_{GD} :

$$\tau = C_{GD} R_{EQ} = C_{GD} (R_D \parallel R_L)$$



Grille commune

- On considère maintenant C_{GS} :
 - On met C_{GD} en circuit ouvert
 - On remplace C_{GS} par une source de courant
 - On trouve V_+ et V_- .



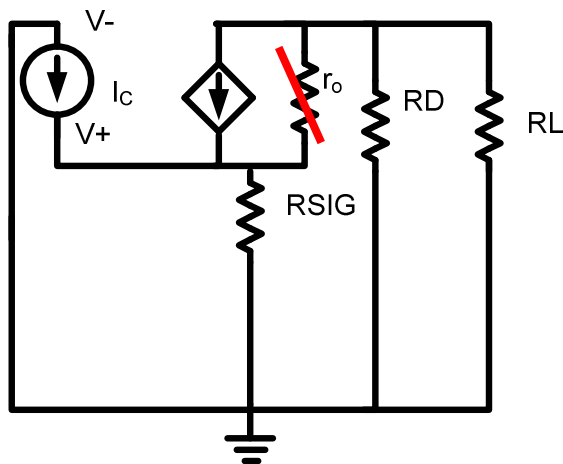
$$I_C + g_m (v_- - v_+) = \frac{v_+}{R_{SIG}}$$

Grille commune

- On met les v_+ a droite:

$$I_C + g_m(v_- - v_+) = \frac{v_+}{R_{SIG}} \quad \Rightarrow \quad I_C + g_m v_- = v_+ \left(\frac{1}{R_{SIG}} + g_m \right)$$

- Sachant que v_- est 0, l'equation devient:



$$I_C = v_+ \left(\frac{1}{R_{SIG}} + g_m \right)$$

Grille commune

- On peut donc trouver R_{EQ} :

$$I_C = v_+ \left(\frac{1}{R_{SIG}} + g_m \right) \quad \Rightarrow \quad R_{EQ} = \left(R_{SIG} \parallel \frac{1}{g_m} \right)$$

- On calcule la constante de temps:

$$\tau = C_{GS} R_{EQ} = C_{GS} \left(R_{SIG} \parallel \frac{1}{g_m} \right)$$

- Dans cette methode, on addition les τ
 - On inverse ensuite pour trouver ω_{-3dB}

Grille commune

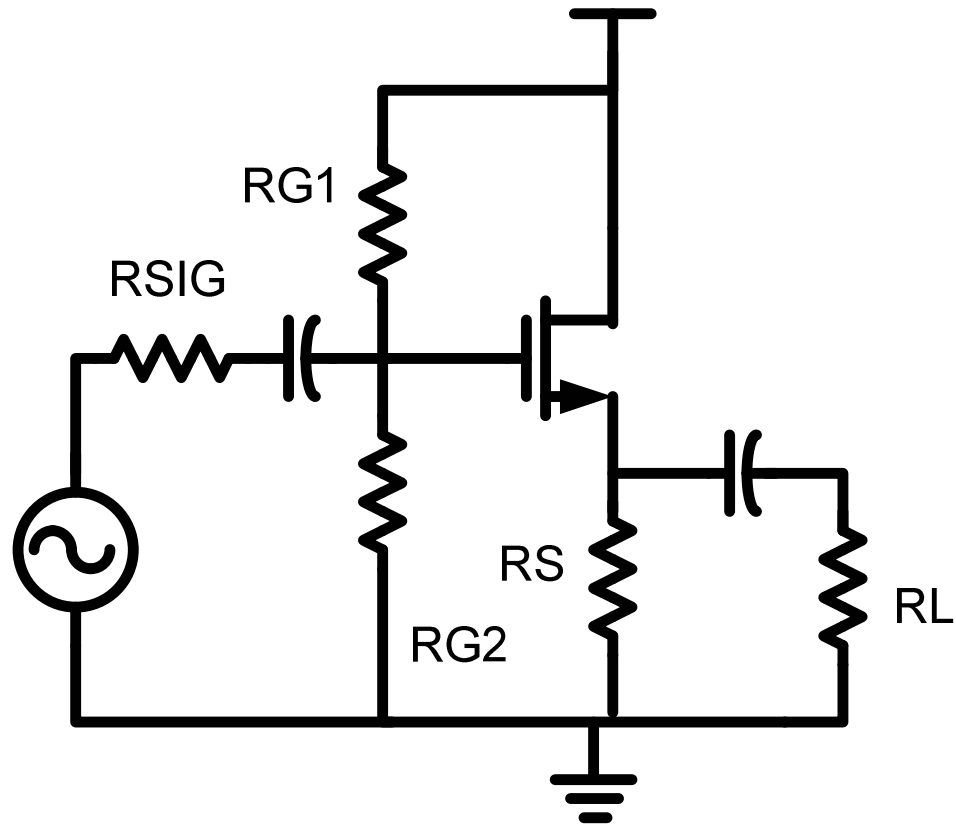
- La fréquence de coupure est:

$$\omega_{-3dB} = \frac{1}{\tau_1 + \tau_2} = \frac{1}{C_{GD}(R_D \parallel R_L) + C_{GS}\left(R_{SIG} \parallel \frac{1}{g_m}\right)}$$

- R_{SIG} et $1/g_m$ sont petites, donc contribution moindre
- La grosse contribution vient de R_L et R_D .

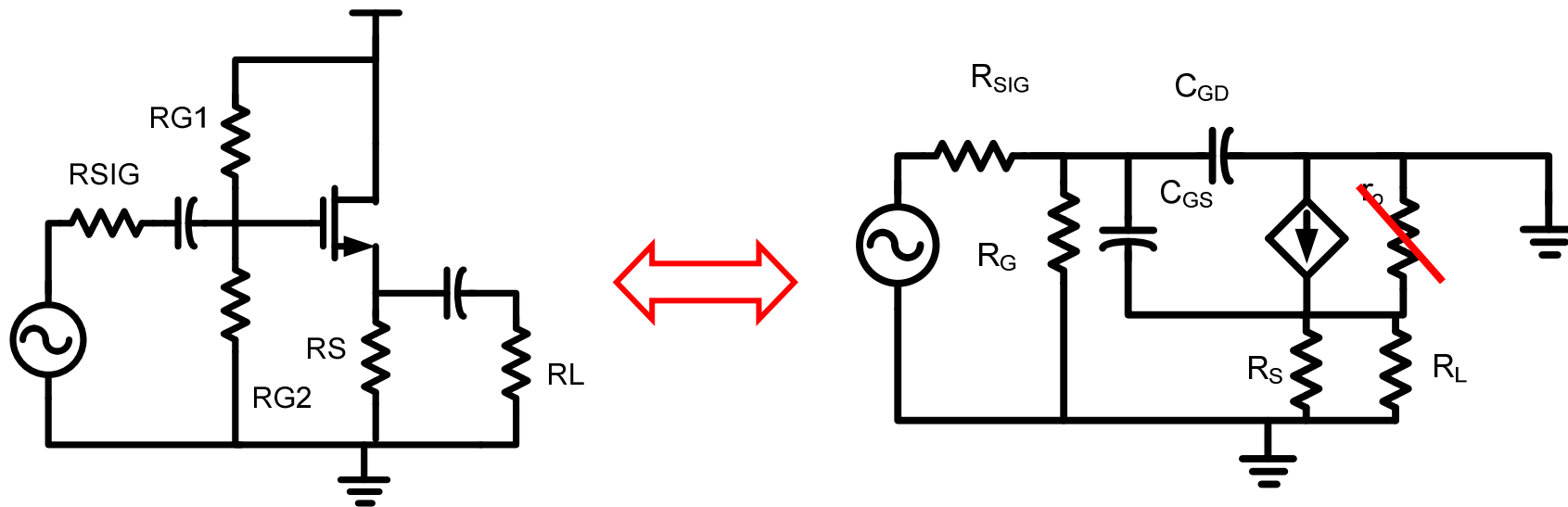
Drain commun

- La dernière configuration c'est le drain commun



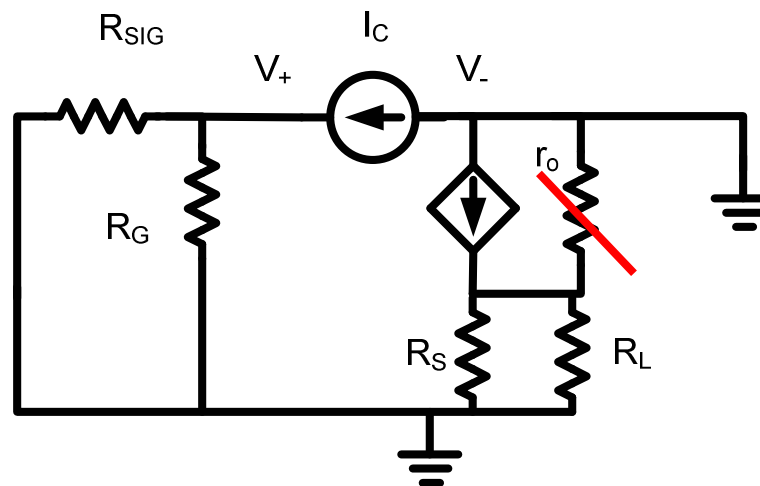
Drain commun

- Le modele petit signal est:
 - On ignore r_o



Drain commun

- On commence avec le C_{GD}
 - La source dependante devient 0
 - C_{GS} est en circuit ouvert
 - On remplace C_{GD} par une source de courant
 - On calcule V_+ et V_-
 - On trouve R_{EQ}



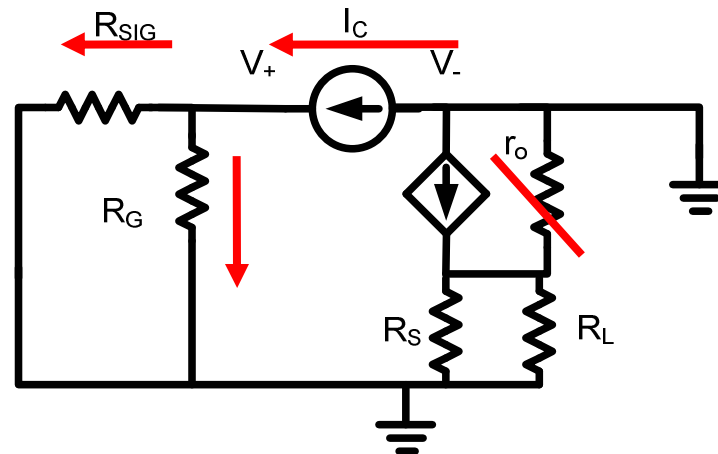
Drain commun

- On écrit l'équation du courant

$$I_C = \frac{V_+}{R_{SIG} \parallel R}$$

- On isole V_+ :

$$v_+ = I_C (R_{SIG} \parallel R_G)$$



$$v_- = 0$$

Drain commun

- On peut trouver la resistance equivalente:

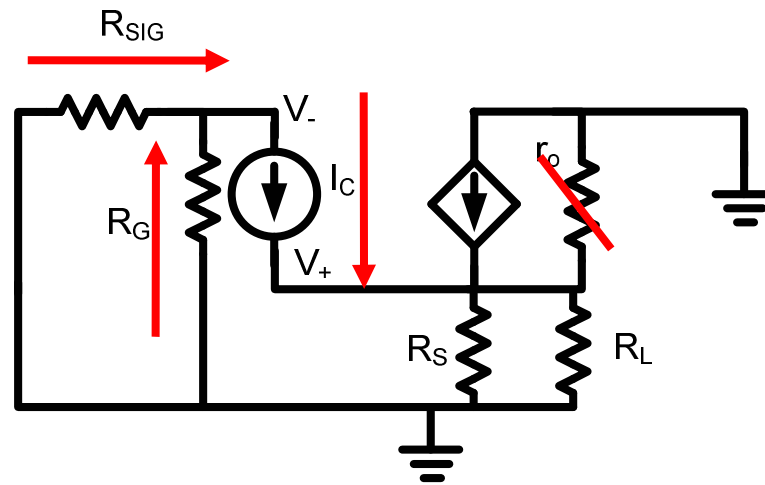
$$R_{EQ} = \frac{v_+ - v_-}{I_C} = (R_{SIG} \parallel R_G)$$

- La constante de temps pour C_{GD} est:

$$\tau = C_{GD} R_{EQ} = C_{GD} (R_{SIG} \parallel R_G)$$

Drain commun

- On considère C_{GS} :

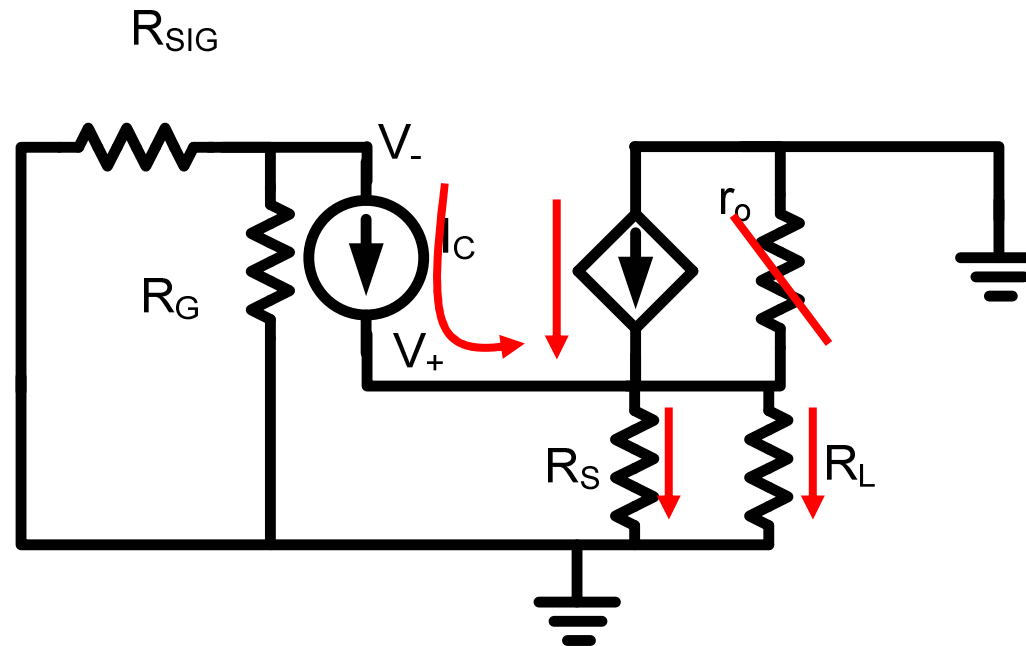


- On écrit l'équation du courant

$$\frac{0 - v_-}{R_{SIG} \parallel R_G} = I_C \quad \Rightarrow \quad v_- = -I_C (R_{SIG} \parallel R_G)$$

Drain commun

- Il faut maintenant trouver V_+ :
 - On écrit l'équation au noeud de sortie



$$I_C + g_m (v_- - v_+) = \frac{v_+}{(R_S \parallel R_L)}$$

Drain commun

- On amène les v_+ à droite:

$$I_C + g_m(v_- - \underline{v_+}) = \frac{v_+}{(R_S \parallel R_L)} \quad \Rightarrow \quad I_C + g_m v_- = \frac{v_+}{(R_S \parallel R_L)} + g_m v_+$$

- On substitue v_- :

$$\underline{I_C - g_m I_C (R_{SIG} \parallel R_G)} = \frac{v_+}{(R_S \parallel R_L)} + g_m v_+$$

- On factorise v_+ :

$$I_C - g_m I_C (R_{SIG} \parallel R_G) = v_+ \left[\frac{1}{(R_S \parallel R_L)} + g_m \right]$$

Drain commun

- On isole v_+

$$\frac{I_C - g_m I_C (R_{SIG} \parallel R_G)}{\frac{1}{(R_S \parallel R_L)} + g_m} = v_+$$

- On simplifie

$$\frac{I_C [1 - g_m (R_{SIG} \parallel R_G)] (R_S \parallel R_L)}{[1 + g_m (R_S \parallel R_L)]} = v_+$$

Drain commun

- On trouve maintenant R_{EQ}

$$R_{EQ} = \frac{v_+ - v_-}{I_C} = \frac{\overbrace{I_C [1 - g_m (R_{SIG} \parallel R_G)] (R_S \parallel R_L)}^{V_+} - \overbrace{[-I_C (R_{SIG} \parallel R_G)]}^{V_-}}{I_C}$$

- En manipulant un peu, on obtient

$$R_{EQ} = \frac{(R_S \parallel R_L) + (R_{SIG} \parallel R_G)}{[1 + g_m (R_S \parallel R_L)]}$$

Drain commun

- La constante de temps est:

$$\tau = C_{GS} \frac{(R_S \parallel R_L) + (R_{SIG} \parallel R_G)}{[1 + g_m (R_S \parallel R_L)]}$$

- On trouve la fréquence de coupure:

$$\omega_{-3dB} = \frac{1}{C_{GS} \frac{(R_S \parallel R_L) + (R_{SIG} \parallel R_G)}{[1 + g_m (R_S \parallel R_L)]} + C_{GD} (R_{SIG} \parallel R_G)}$$

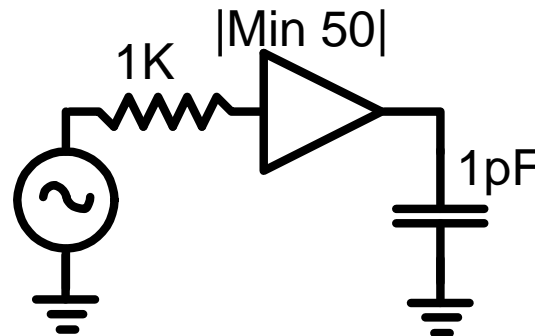
Passons à quelque chose de plus concret..

Exemple de Conception

- On recapitule:
 - Nous avons explore 3 configurations
 - Nous avons utilise une technique d'analyse "rapide" de la vitesse
- Qu'est-ce qu'on est capable de faire?
- Essayons un probleme de conception
 - On part avec des specifications
 - On utilise nos connaissances pour construire quelque chose...

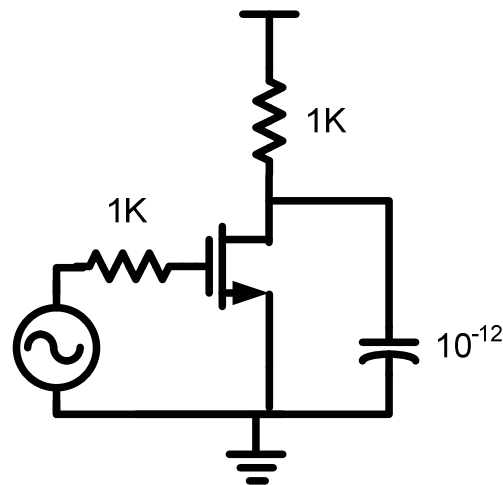
Exemple de Conception

- On veut concevoir un amplificateur qui fonctionne a 1Grad/s qui a un gain de 50.
- Voici les parametres de la technologie:
 - $g_m=0.05$
 - $C_{GD}=50 \times 10^{-15}$
 - $C_{GS}=200 \times 10^{-15}$
- Les contraintes externes sont
 - $C_L=1 \times 10^{-12}$
 - $R_{SIG}=1K$



Exemple de Conception

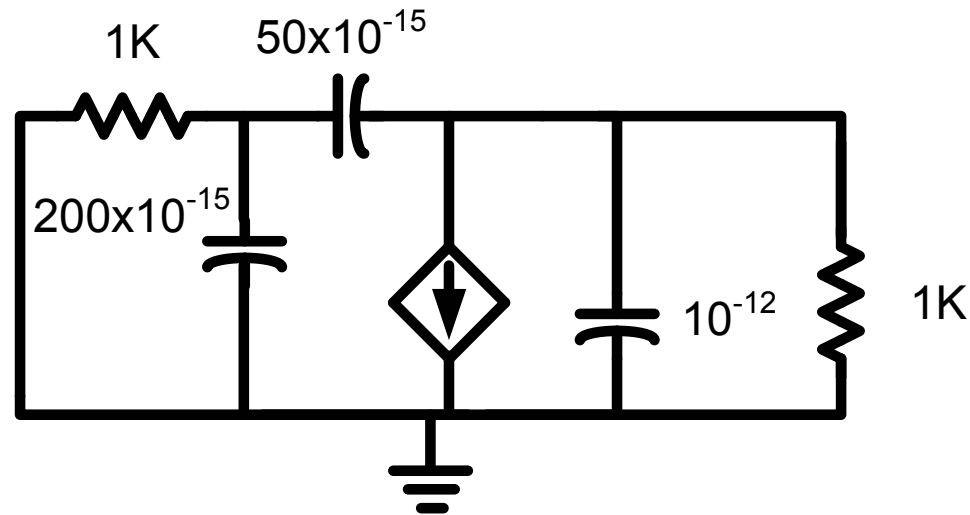
- Donnons-nous un point de depart...
 - Source commune: grand gain et grand R_{IN}
- On va commencer avec une 1^{re} iteration:
 - Gain: $-g_m R_D$
 - Avec $g_m=0.05$ et $R_D=1K$, le gain est -50
 - Est-ce que ca fonctionne a 1Grad/s?



Oublions la polarisation DC!

Exemple de Conception

- On prend le modele petit signal:

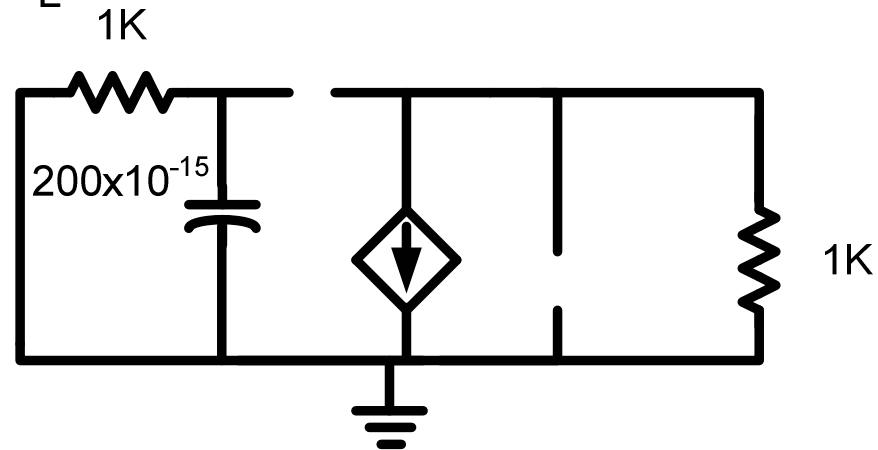


- On calcule ω_{-3dB} avec constantes de temps circuit ouvert

On commence avec C_{GS}

Exemple de Conception

- Avec C_{GS} :
 - C_{GD} et C_L sont en circuit ouvert



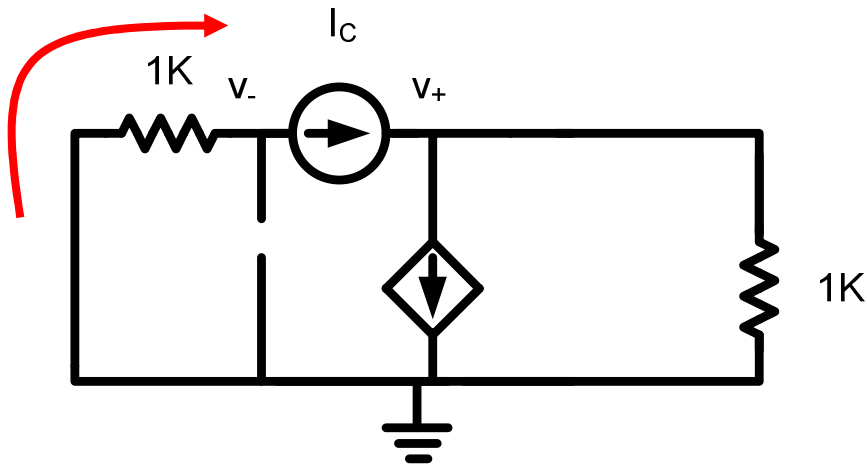
- C_{GS} voit seulement la resistance 1K

$$\tau = C_{GS} R_{EQ} = (200 \times 10^{-15})(1000) = 200 \times 10^{-12}$$

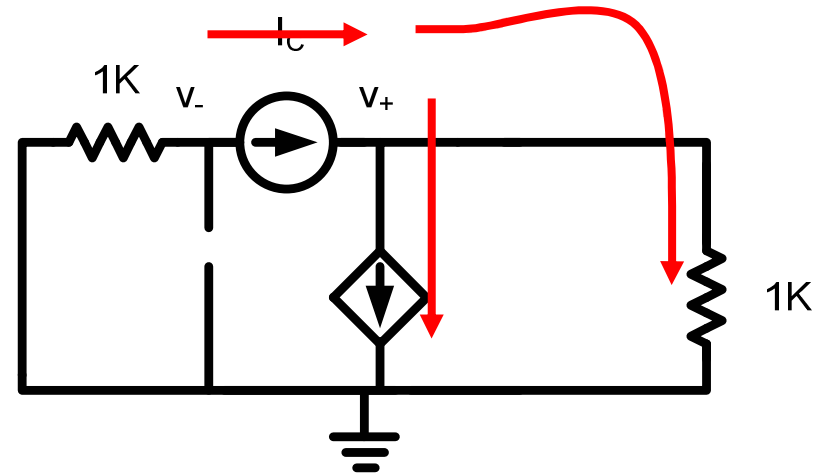
Passons a C_{GD} ...

Exemple de Conception

- Pour C_{GD} :
 - C_{GS} et C_L sont en circuit ouvert
- Pour trouver R_{EQ} de C_{GD} , on applique un courant:



$$v_- = -I_C 1K$$



$$v_+ = (I_C - g_m v_-) 1K \quad 45$$

Exemple de Conception

- On manipule les equations:

$$v_+ - v_- = (I_C + g_m I_C 1K)1K + I_C 1K$$

- On isole R_{EQ} :

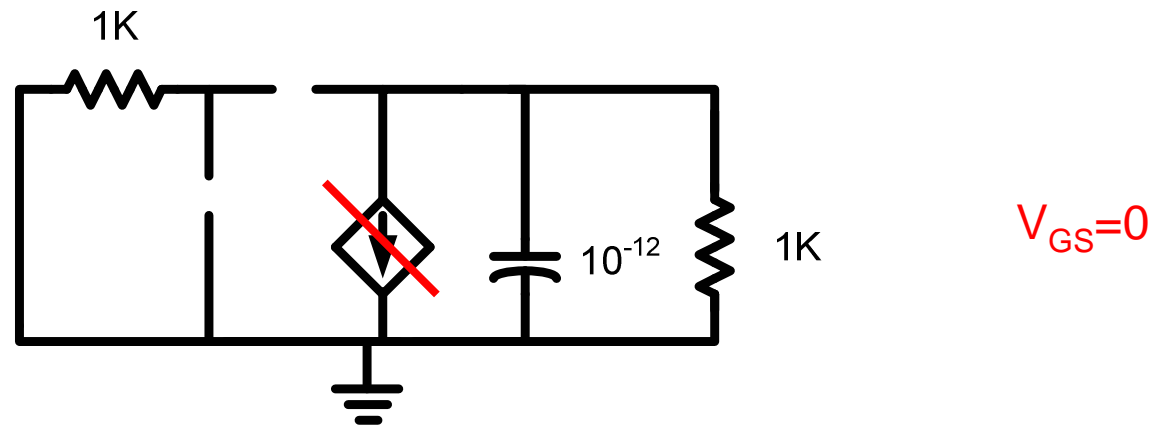
$$R_{EQ} = \frac{v_+ - v_-}{I_C} = (1 + g_m 1K)1K + 1K = 52K$$

- La constante de temps est:

$$\tau = C_{GD} R_{EQ} = 52K(50 \times 10^{-15}) = 2.6 \times 10^{-9}$$

Exemple de Conception

- Il reste une capacite: C_L .
 - C_{GS} et C_{GD} sont en circuit ouvert



- La source dependante a 0 courant. Donc, la constante de temps est:

$$\tau = C_L R_{EQ} = 10^{-9}$$

Exemple de Conception

- Pour la fréquence de coupure, on additionne les constantes de temps:

$$\underset{C_{GS}}{200 \times 10^{-12}} + \underset{C_{GD}}{2.6 \times 10^{-9}} + \underset{C_L}{10^{-9}} = 3.8 \times 10^{-9}$$

- Ca nous donne une fréquence de coupure de:

$$263 \text{ Mrad} / \text{ s}$$

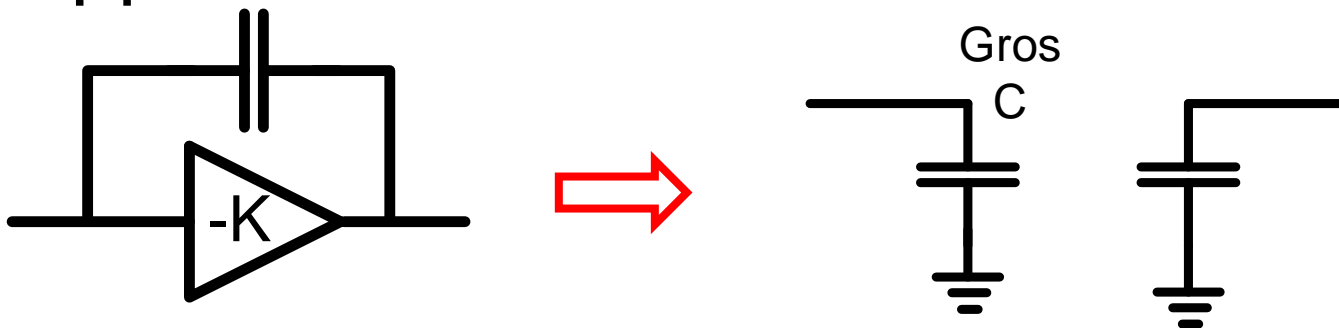
Avec 263Mrad/s, on est beaucoup trop lent... qu'est-ce qu'on fait?

Exemple de Conception

- Regardons les τ :

$$\tau_L = 10^{-9} \quad \tau_{GS} = 200 \times 10^{-12} \quad \tau_{GD} = 2.6 \times 10^{-9}$$

- La plus grosse contribution est 2.6ns (C_{GD})
- La raison:
 - Source commune a une capacite de Miller
- Rappel:



Gros gain

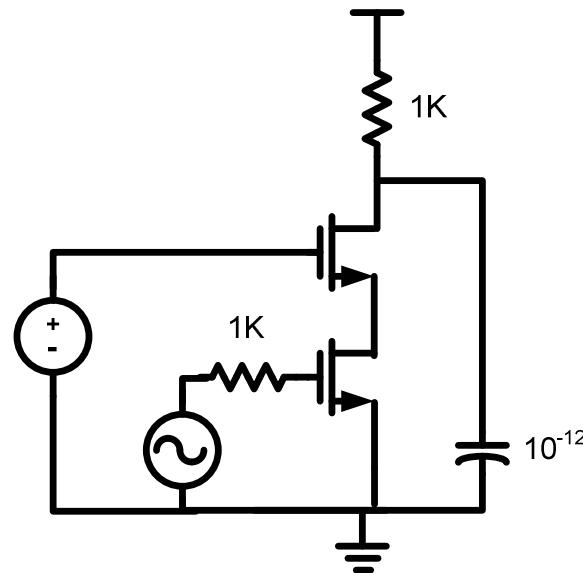
Exemple de Conception

- Comment résoudre? 2 façons:
 - Réduire le R que voit le C (R de la source)
 - Réduire le gain aux bornes de C
- On peut utiliser une configuration cascode
 - Source commune + base commune

1. R_D de source commune devient R_{IN} de grille commune

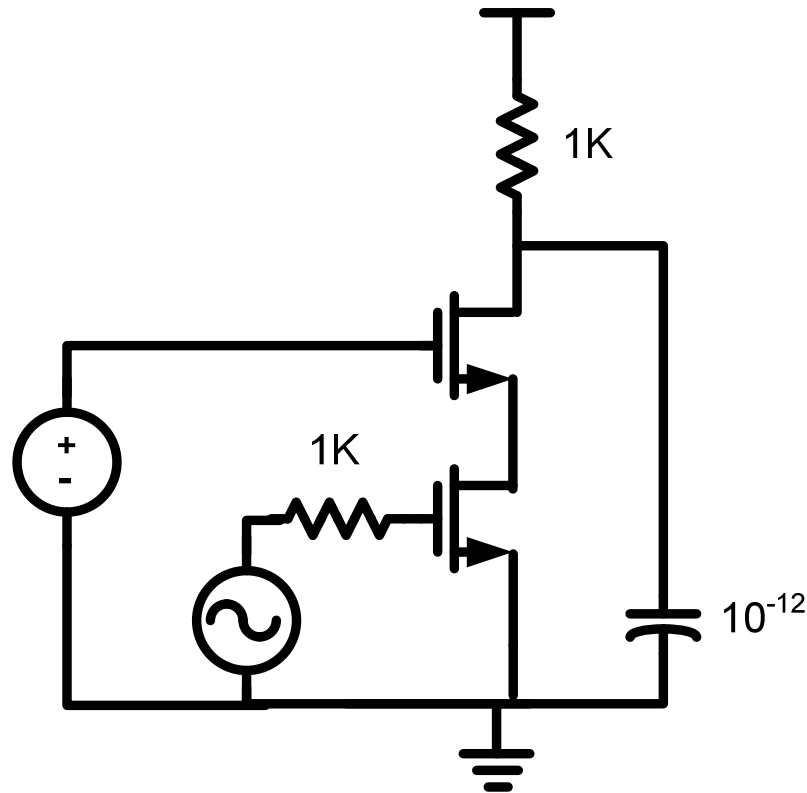
2. Gain devient ~ 1 aux bornes de C (Miller disparaît)

3. Gain de base commune: $g_m R_D$ (même gain)



Exemple de Conception

- On obtiendrait ce circuit

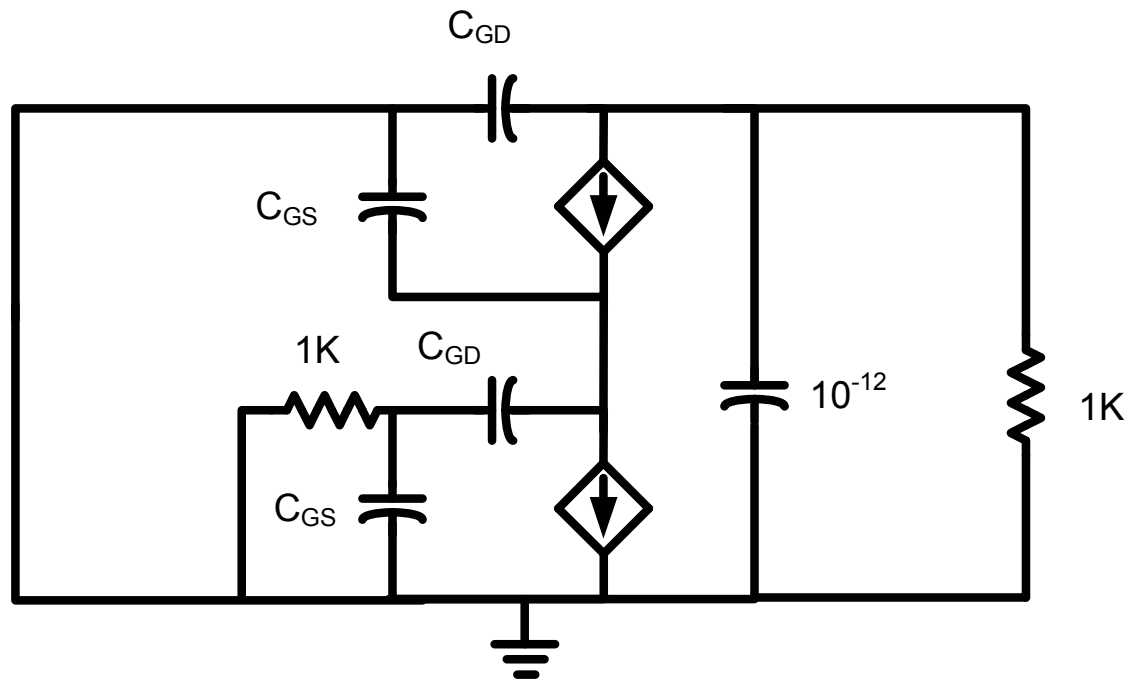


Le gain est encore ~50

Calculons la fréquence de coupure...

Exemple de Conception

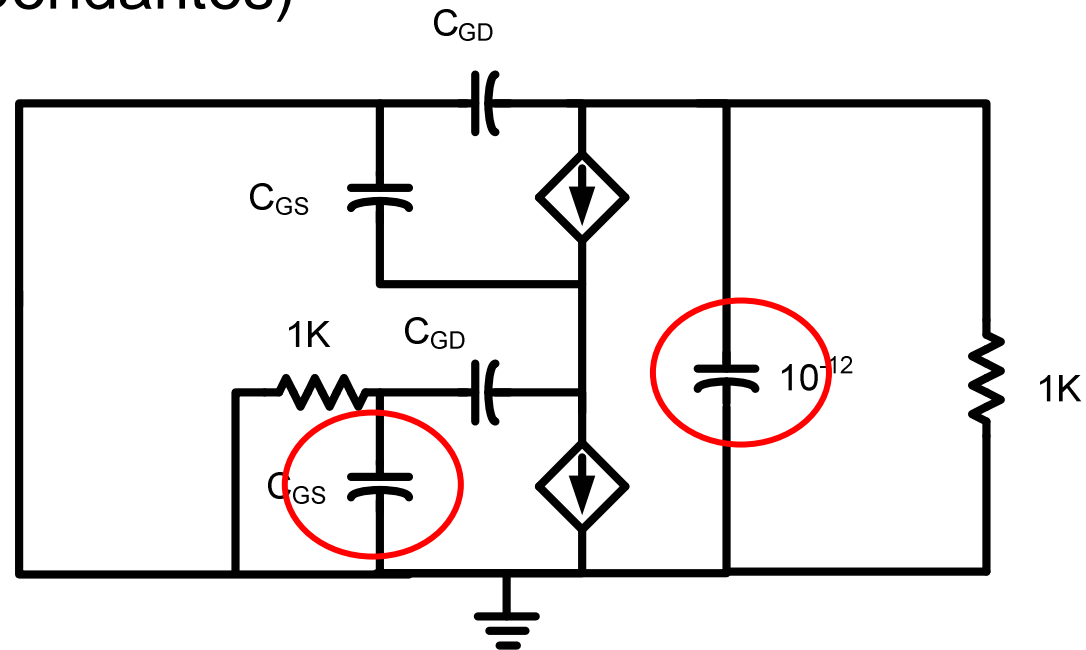
- Le modele petit signal est celui-ci:



On est maintenant rendu avec 5 capacites... essayons de reutiliser des resultats

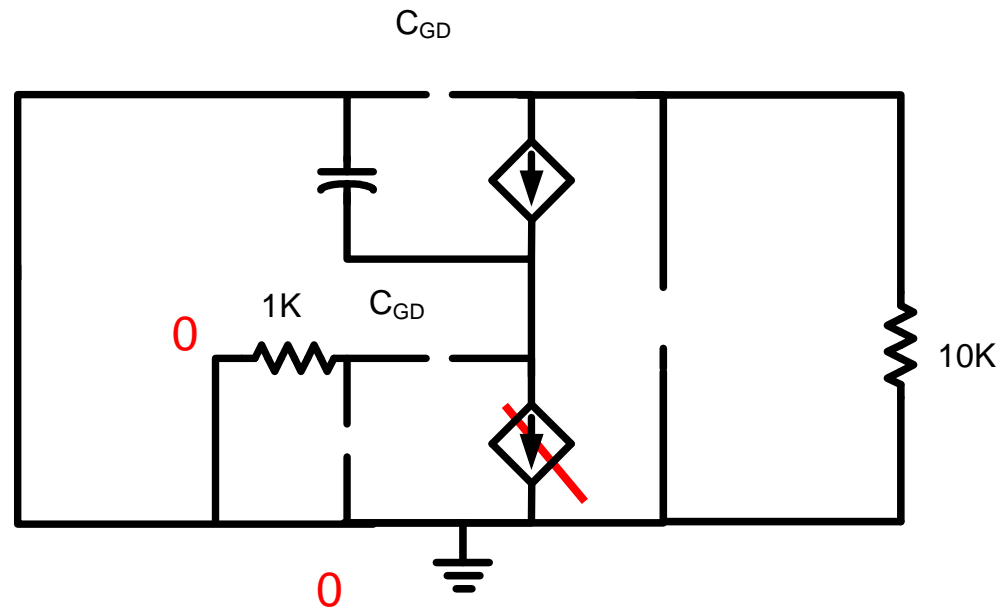
Exemple de Conception

- Voyons ce qu'on peut reprendre de l'autre analyse:
 - C_{GS} du premier transistor reste le meme
 - C_L reste le meme (aucun courant dans les sources dependantes)



Exemple de Conception

- Il reste 3 condensateurs.
- Considerons le 2e C_{GS} :
 - La source dependante du bas est 0



Voyons la source du haut...

Exemple de Conception

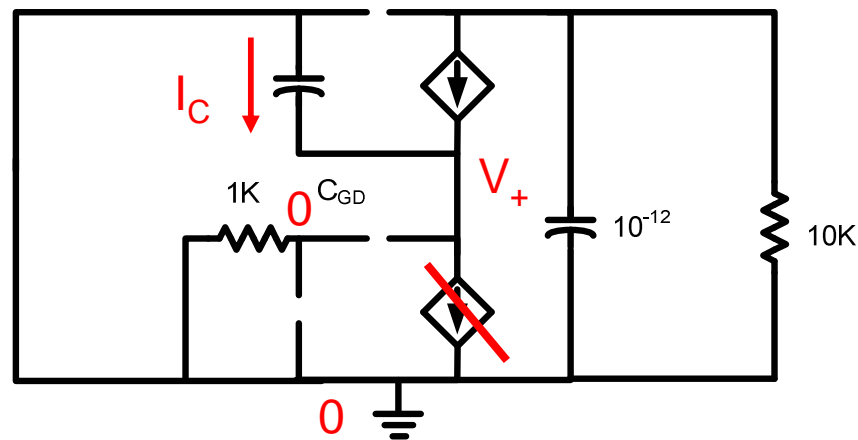
- On écrit l'équation au noeud V_+ :

$$I_C + g_m (0 - v_+) = 0$$

- On isole V_+

$$\frac{I_C}{g_m} = v_+$$

$$v_- = 0$$



Exemple de Conception

- La resistance equivalente est:

$$R_{EQ} = \frac{v_+ - v_-}{I_C} = \frac{1}{g_m}$$

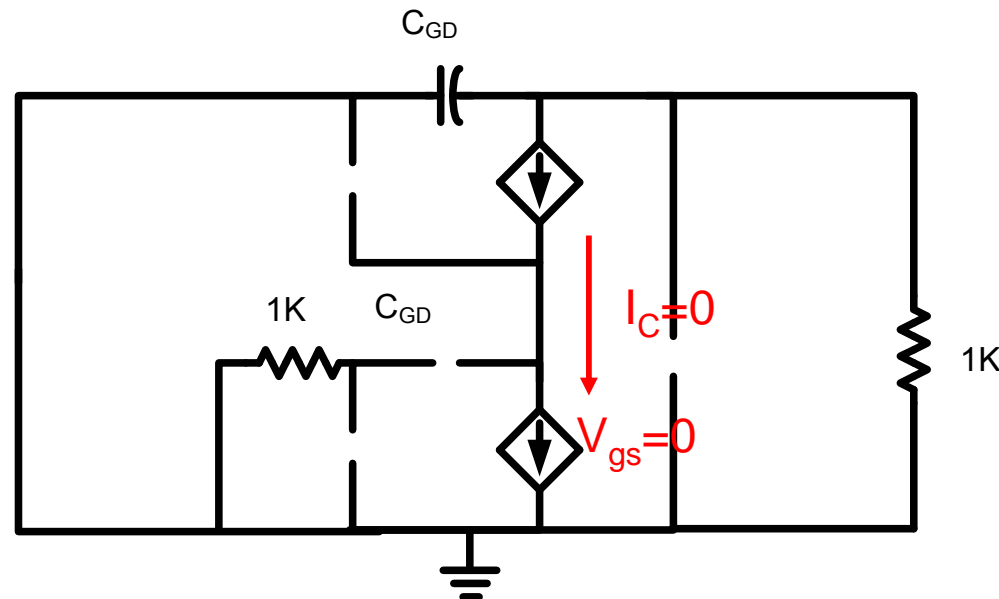
- La constante de temps est:

$$\tau = C_{GS} \frac{1}{g_m} = 4 \times 10^{-12}$$

Exemple de Conception

- Considerons maintenant le C_{GD} en haut.
- Aucun courant ne passe dans les sources dependantes: $R_{EQ}=1K$

$$\tau = (1K)(50 \times 10^{-15}) = 50 \times 10^{-12}$$

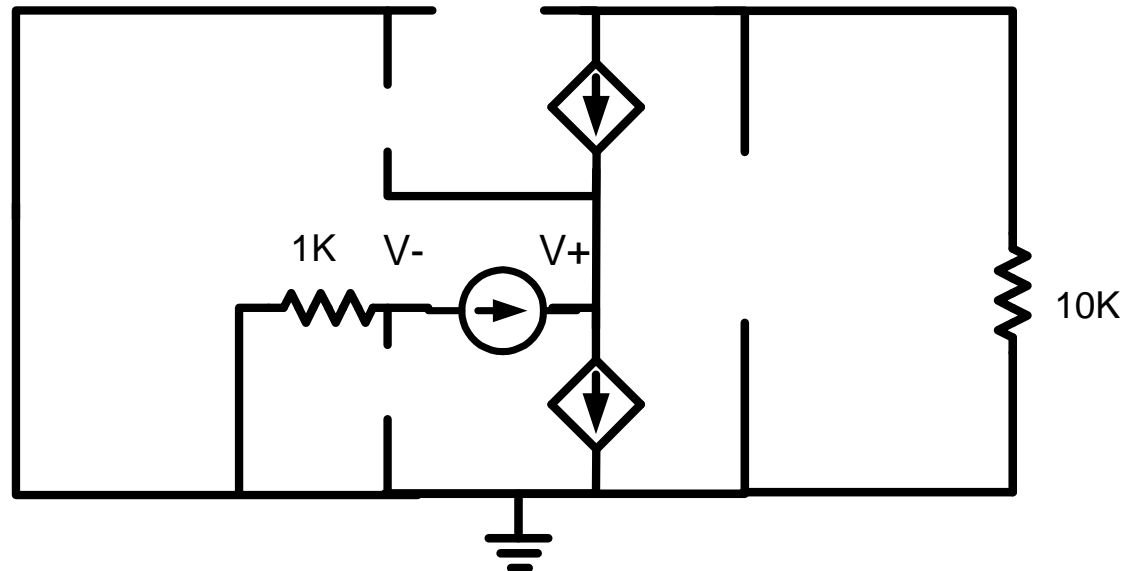


Exemple de Conception

- Le dernier C_{GD} demande plus de travail:
 - On écrit l'équation à V_- :

$$v_- = -I_C 1K$$

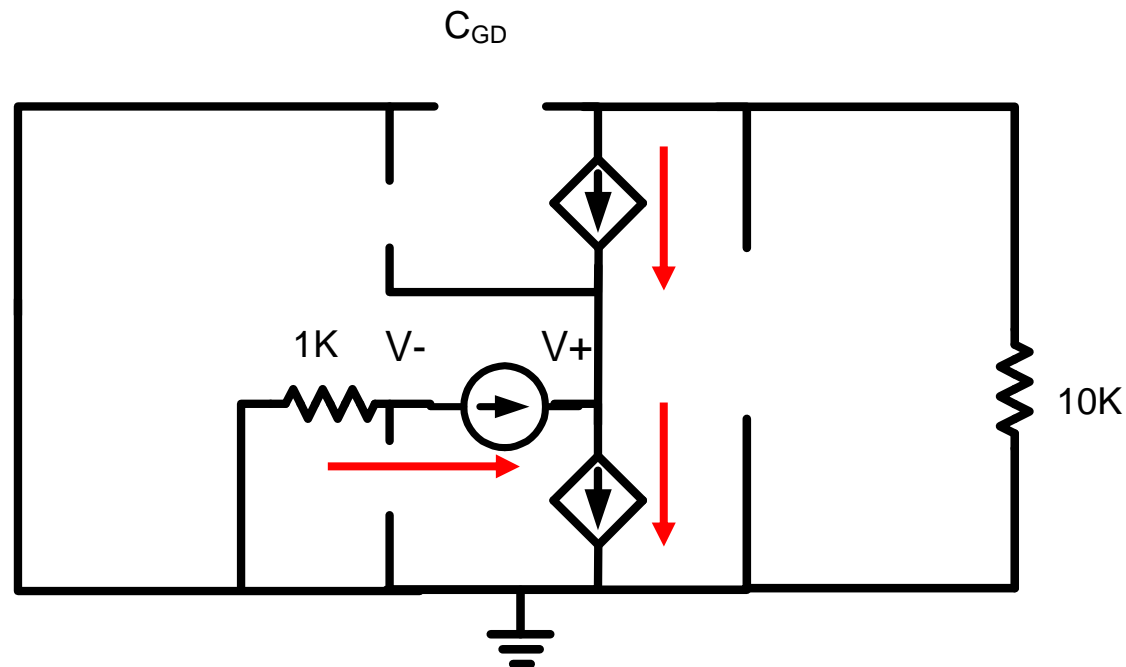
C_{GD}



Exemple de Conception

- On fait la meme chose pour V_+ :

$$I_C + g_m (0 - v_+) = g_m (v_- - 0)$$



Exemple de Conception

- On recopie les 2 equations ici:

$$v_- = -I_C 1K \qquad I_C + g_m (0 - v_+) = g_m (v_- - 0)$$

- On substitue V_- dans l'equation de V_+ :

$$I_C + g_m (-v_+) = g_m \underline{(-I_C 1K)}$$

- On isole V_+ :

$$I_C \left(\frac{1 + 1Kg_m}{g_m} \right) = v_+$$

Exemple de Conception

- On fait $V_+ - V_-$ pour trouver R_{EQ} :

$$v_+ - v_- = I_C \left(\frac{1 + 1K g_m}{g_m} \right) + I_C 1K$$

- On isole la resistance equivalente:

$$R_{EQ} = \frac{v_+ - v_-}{I_C} = 2020$$

- La constante de temps est:

$$\tau = 101 \times 10^{-12}$$

Exemple de Conception

- La somme des constantes de temps nous aide a trouver la frequence de coupure:

$$\tau_{GS1} \Rightarrow 200x10^{-12}$$

$$\tau_{GS2} \Rightarrow 4x10^{-12}$$

$$\tau_{GD1} \Rightarrow 101x10^{-12}$$

$$\tau_{GD2} \Rightarrow 50x10^{-12}$$

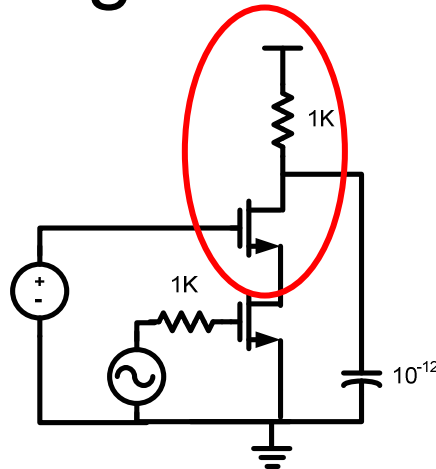
$$\tau_L \Rightarrow 10^{-9}$$

$$200x10^{-12} + 101x10^{-12} + 50x10^{-12} + 4x10^{-12} + 10^{-9} = 1.355x10^{-9}$$

$$\Rightarrow 738Mrad / s$$

Exemple de Conception

- La grosse contribution maintenant, c'est la capacité de sortie C_L ($\tau = C_L * R_D$)
- On sait que C_L voit R_D (1K)
 - R_D c'est R_{OUT} de la configuration cascode
 - Il faut lui montrer une plus petite resistance que 1K
- Il faut une configuration avec petit R_{OUT}

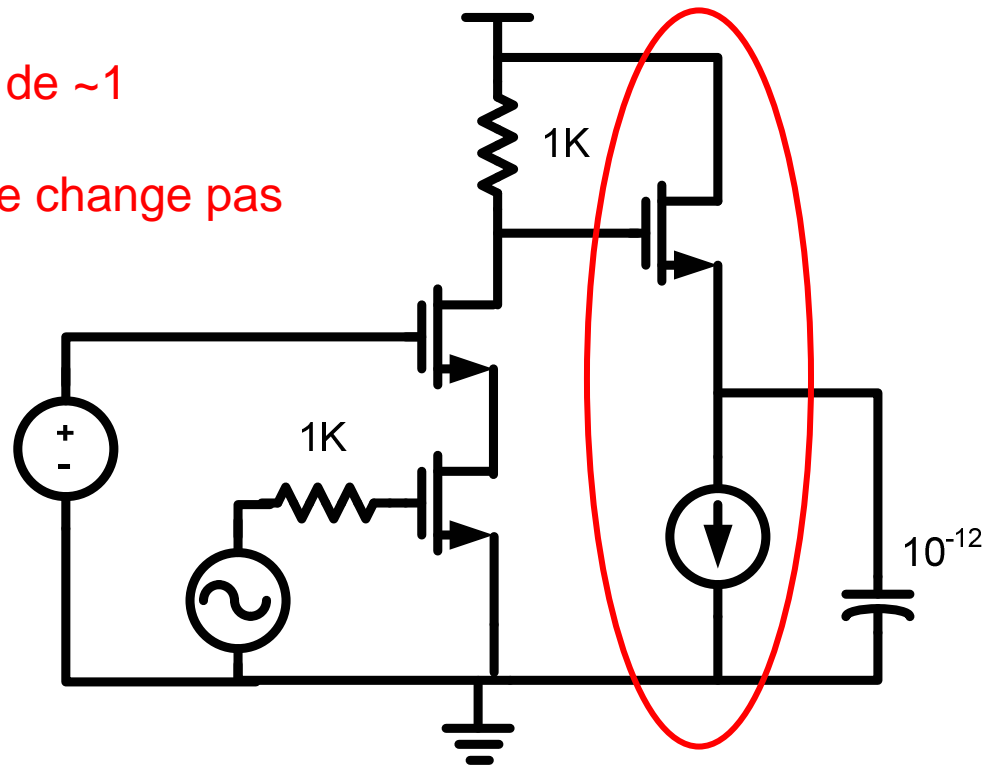


Exemple de Conception

- La configuration drain commun est ajoutée pour présenter un faible R_{OUT} a C_L :

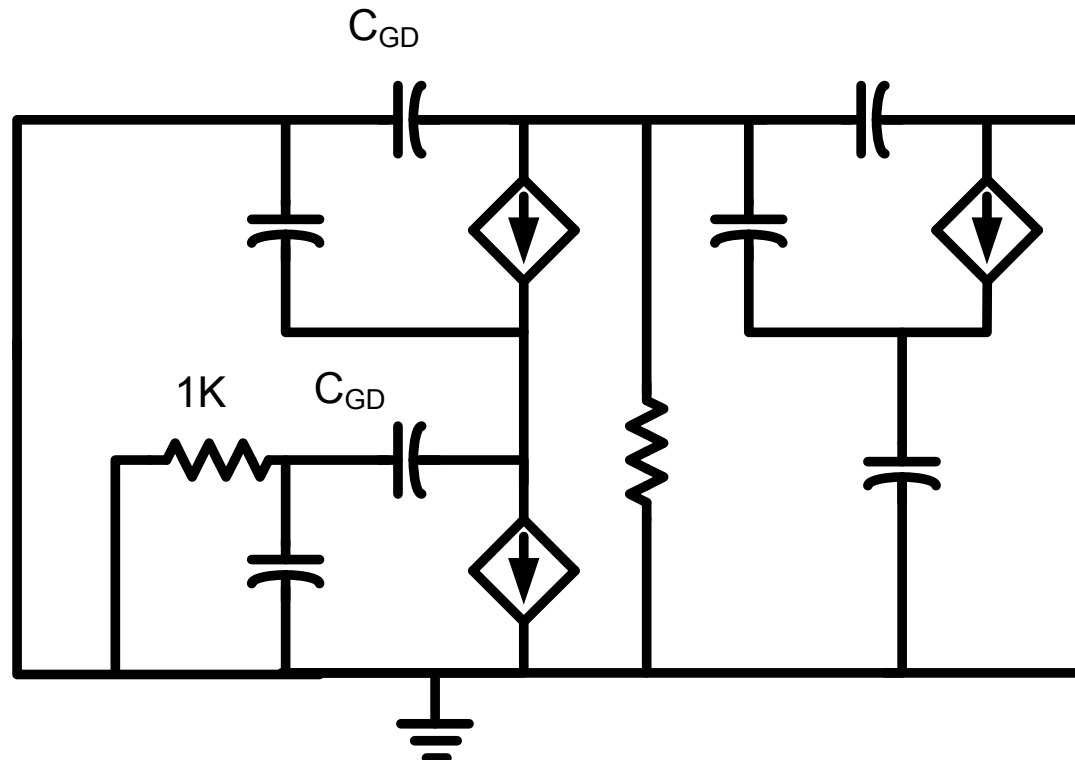
Drain commun a un gain de ~ 1

Encore une fois, le gain ne change pas



Exemple de Conception

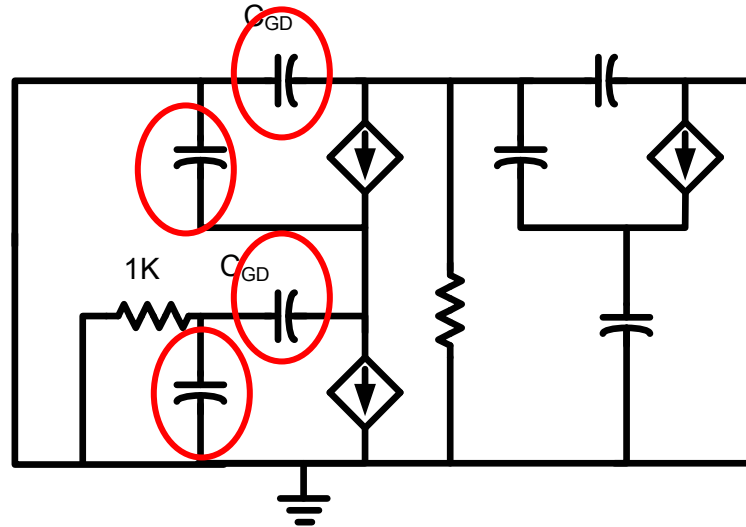
- Le modele petit signal est:



On est maintenant rendu a 7 condensateurs...Voyons ce qu'on peut reutiliser

Exemple de Conception

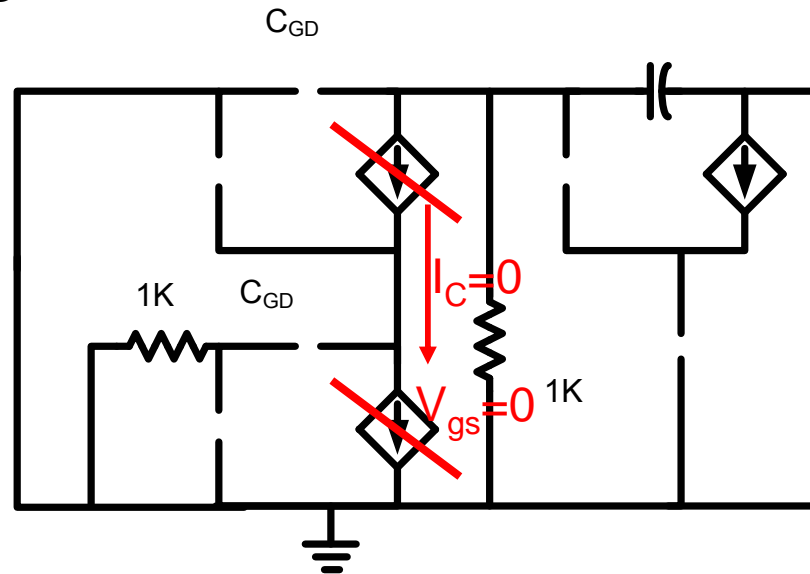
- Les C_{GS} et C_{GD} des 2 premiers transistors restent les memes.



- Il faut seulement calculer la constante de temps pour les 3 condensateurs restants

Exemple de Conception

- Le C_{GD} de la sortie
 - On sait que les 2 sources dependantes sont 0
 - Le courant ne passe QUE dans le 1K
 - Ce C_{GD} voit seulement 1K



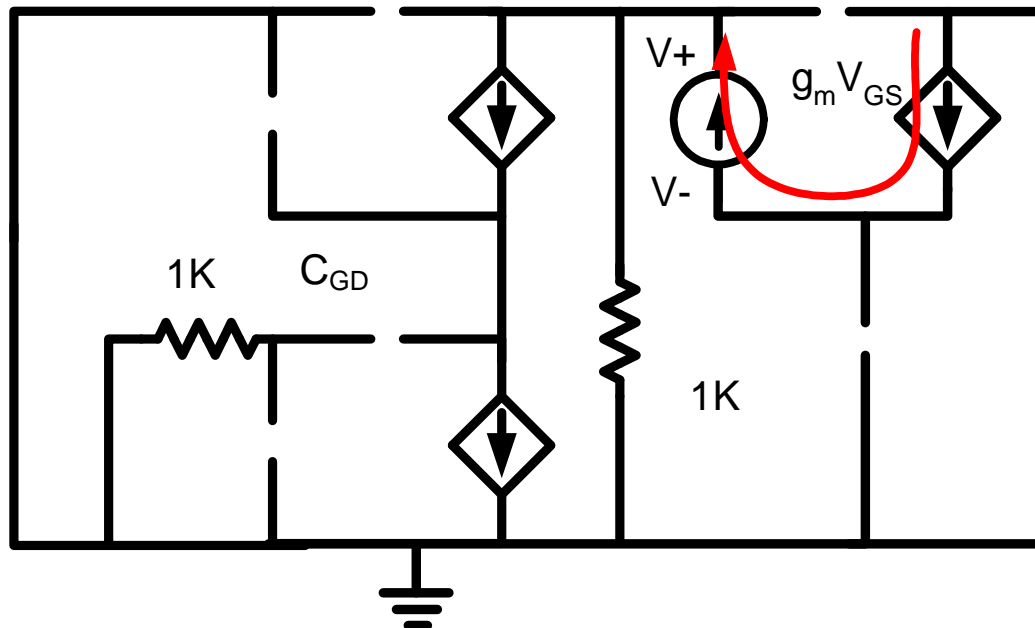
$$\tau = (1K)(50 \times 10^{-15}) = 50 \times 10^{-12}$$

Exemple de Conception

- Le C_{GS} a la sortie
 - Le courant dans la source dependante:

$$I_C = g_m (v_+ - v_-)$$

C_{GD}



Exemple de Conception

- La resistance equivalente est:

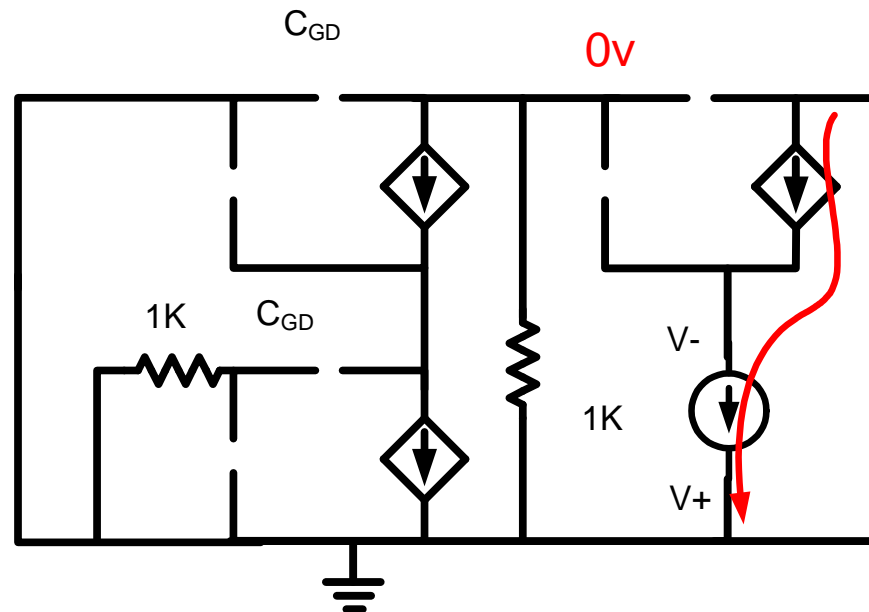
$$I_C = g_m (v_+ - v_-) \quad \Rightarrow \quad R_{EQ} = \frac{(v_+ - v_-)}{I_C} = \frac{1}{g_m}$$

- La constante de temps est:

$$\tau = C_{GS} \frac{1}{g_m} = 4 \times 10^{-12}$$

Exemple de Conception

- Le dernier condensateur, c'est C_L :



- On écrit l'équation du courant:

$$I_C = g_m (0 - v_-)$$

Exemple de Conception

- On isole v_- :

$$I_C = g_m (0 - v_-) \quad \Rightarrow \quad -\frac{I_C}{g_m} = v_-$$

- La resistance equivalente est:

$$R_{EQ} = \frac{(v_+ - v_-)}{I_C} \quad \Rightarrow \quad R_{EQ} = \frac{1}{g_m}$$

- La constante de temps est:

$$\tau = R_{EQ} C_L = 20 \times 10^{-12}$$

Exemple de Conception

- Pour la fréquence de coupure, on additionne les constantes de temps:

$$C_{GS1} \Rightarrow 200x10^{-12}$$

$$C_{GS2} \Rightarrow 4x10^{-12}$$

$$C_{GD1} \Rightarrow 101x10^{-12}$$

$$C_{GD2} \Rightarrow 50x10^{-12}$$

$$C_{GS3} \Rightarrow 4x10^{-12}$$

$$C_L \Rightarrow 20x10^{-12}$$

$$C_{GD3} \Rightarrow 50x10^{-12}$$

$$429x10^{-12}$$



$$2.33Grad / s$$

Frequence plus elevee que ce qui est requis...

Exemple de Conception

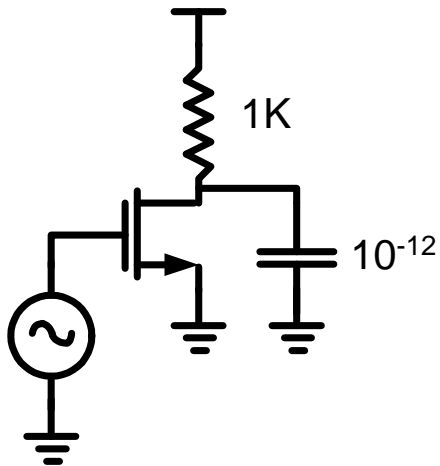
- S'il fallait améliorer, on pourrait tenter de réduire C_{GS1} et C_{GD1}

$$\begin{array}{lll} C_{GS1} \Rightarrow 200 \times 10^{-12} & C_{GD1} \Rightarrow 101 \times 10^{-12} & C_{GS2} \Rightarrow 4 \times 10^{-12} \\ C_{GD2} \Rightarrow 50 \times 10^{-12} & C_{GS3} \Rightarrow 4 \times 10^{-12} & C_{GD3} \Rightarrow 50 \times 10^{-12} \\ & C_L \Rightarrow 20 \times 10^{-12} & \end{array}$$

- Cependant, on est proche de la limite de l'optimisation

Matiere hors cours

- On prend quelques minutes pour introduire une technique avancee...
- Dans la conception haute vitesse on utilise le “shunt-peaking”.
- Imaginez ce circuit:



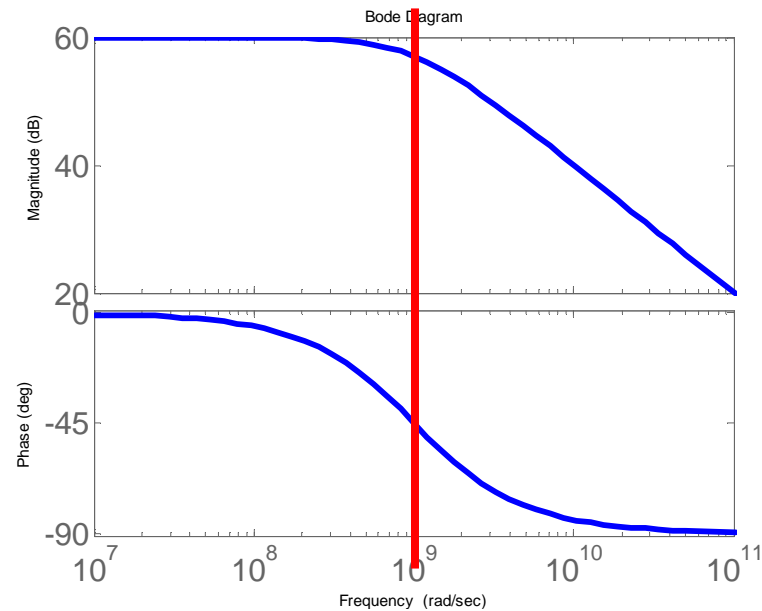
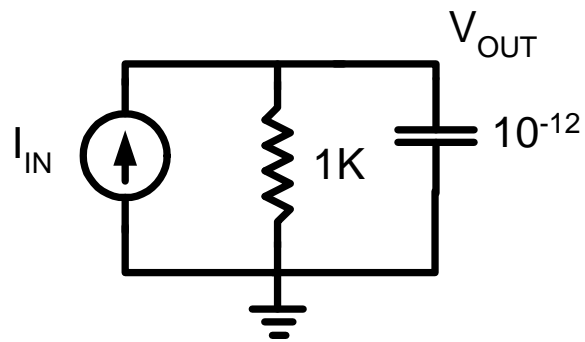
Source ideale: aucun effet de miller

Le probleme se trouve a la sortie

Le probleme se trouve a la sortie (C_L)

Matiere hors cours

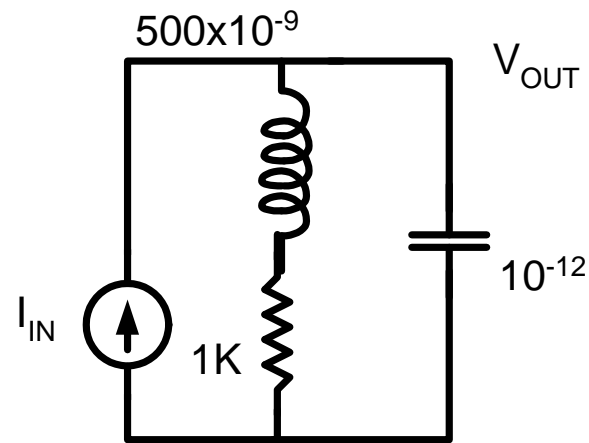
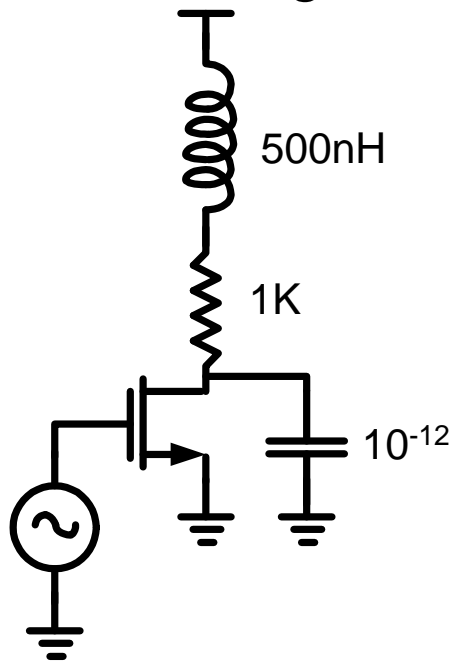
- On fait une analyse rapide
- Si les problemes se trouvent a la sortie (C_L), on peut ignorer les C du transistor



On peut trouver que la frequence de coupure est ~ 1 Grad/s

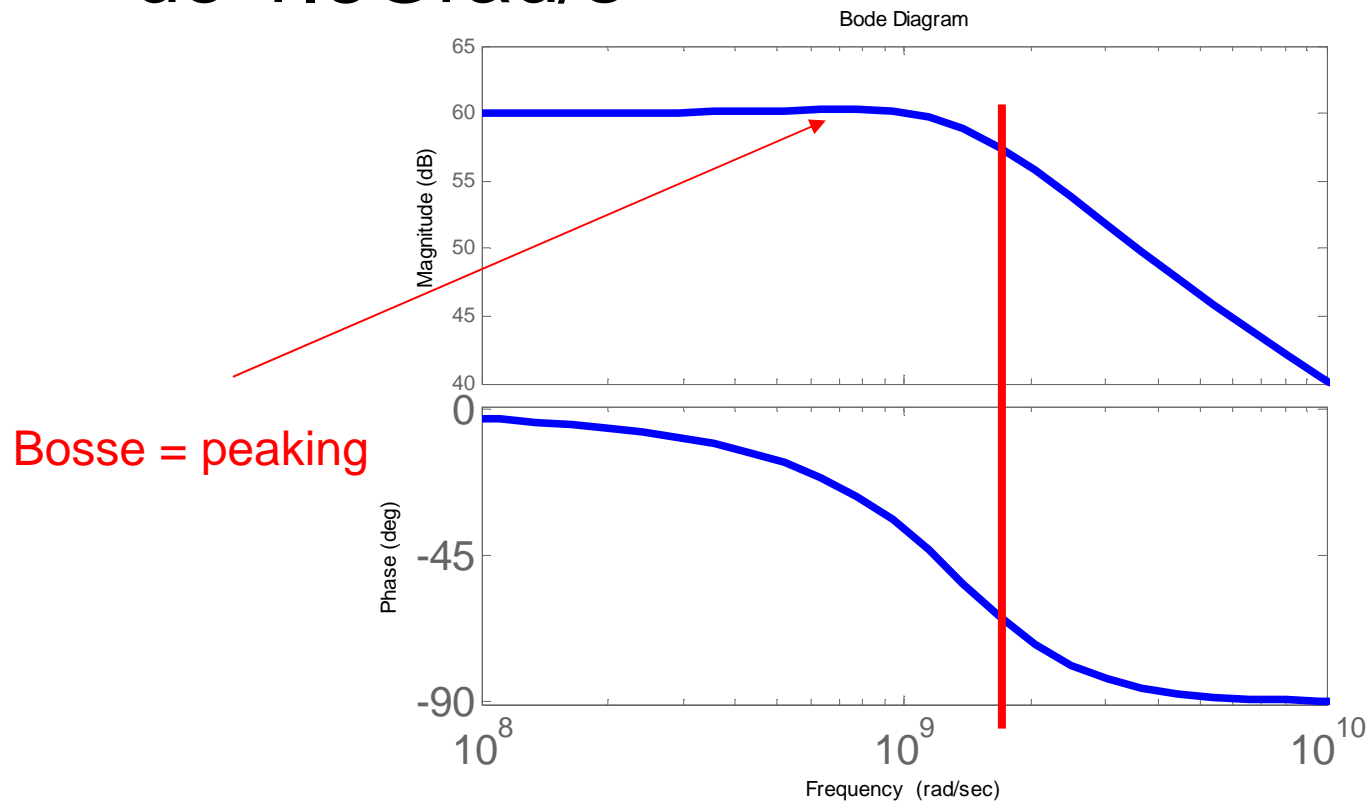
Matiere hors cours

- Avec la technique “shunt-peaking”, on ajoute une inductance...
 - Shunt = parallele (L en parallele avec C)
 - Peaking = “ajout d’une bosse”



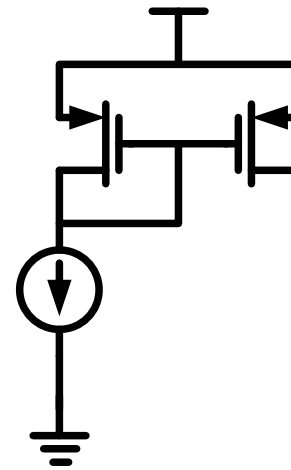
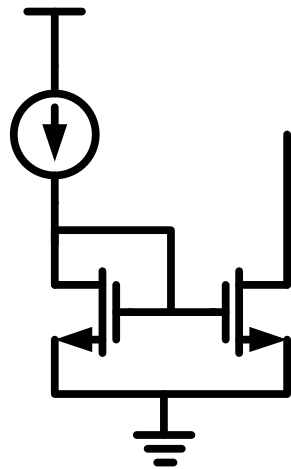
Matiere hors cours

- En faisant l'analyse, on voit que la fréquence de coupure est montée autour de 1.8Grad/s



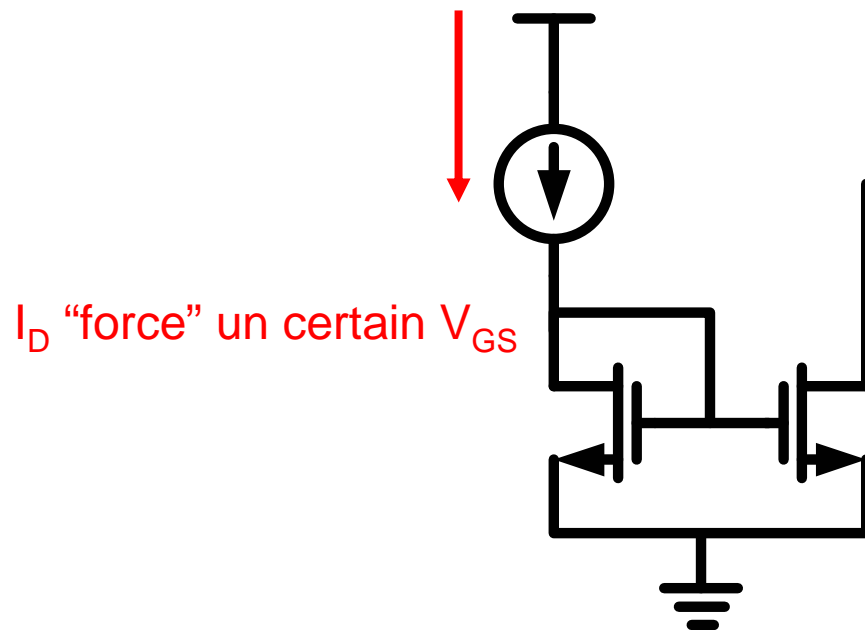
Miroir de courant CMOS

- Comme avec les transistors bipolaires, on peut aussi créer des sources de courant
 - Miroirs de courants
- Voici 2 miroirs de courant simples CMOS:



Miroir de courant CMOS

- Quand un transistor est en saturation, son courant ne depend **que** de V_{GS}
- Donc, meme V_{GS} veut dire meme courant



I_D "force" un certain V_{GS}

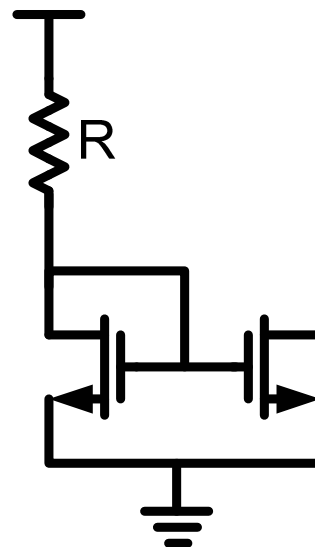
V_{GS} sont les memes

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Miroir de courant CMOS

- En realite:
 - Le courant depend aussi de la tension au drain
 - La taille des transistors (W/L) joue aussi un role
- On va garder ca pour plus tard
- Pour l'instant, analysons ce cas simple...

On utilise R a la place d'une source de courant



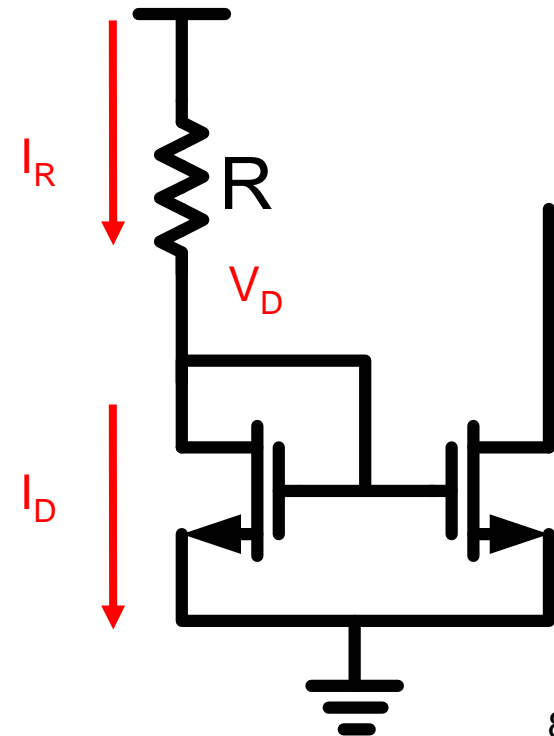
Miroir de courant CMOS

- On sait que: $I_R = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$
- On sait aussi que $V_D = V_{GS}$

$$I_R = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

- Ce courant est egal a I_D

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$



Miroir de courant CMOS

- $I_R = I_D$ et on isole V_{GS} :

$$I_R = \frac{VDD - V_{GS}}{R} \quad \Rightarrow \quad V_{GS} = VDD - I_D R$$

- On substitue dans l'equation de I_D :

$$I_D = \left[\frac{1}{2} \mu C_{OX} \frac{W}{L} \right] (\underline{VDD - I_D R} - V_{TH})^2$$

- On manipule pour obtenir ceci:

$$0 = I_D^2 R^2 - I_D \left[2R(VDD - V_{TH}) + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} \mu C_{OX} \frac{W}{L} \right)} \right] + (VDD - V_{TH})^2$$

C'est facile a resoudre...

Miroir de courant CMOS

- Imaginons un probleme de conception d'un miroir de courant:

- $\mu C_{ox}(W/L)=0.02$
- $V_{TH}=0.7$
- $VDD=5$
- Trouver R pour $I=1mA$

On entre tout ca dans l'equation de tantot

$$0 = (1\mu)R^2 - 1m \left[2R(4.3) + \frac{1}{(0.01)} \right] + (4.3)^2$$

Miroir de courant CMOS

- Le reste devient des mathématiques:

$$0 = 10^{-6} R^2 - R \cdot 8.6 \times 10^{-3} + 18.39$$

- Les solutions sont:

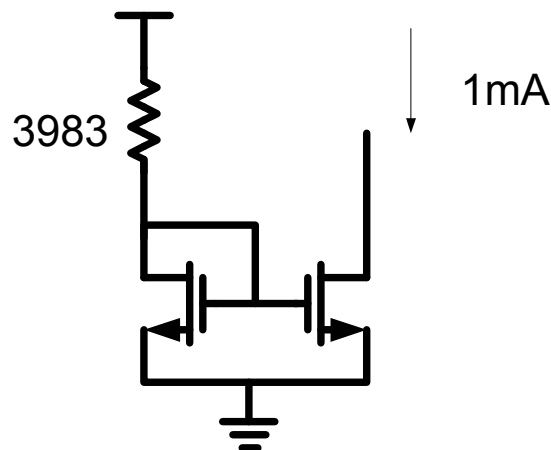
$$\frac{8.6 \times 10^{-3} \pm \sqrt{(8.6 \times 10^{-3})^2 - 4 \times 10^{-6} \cdot 18.39}}{2 \times 10^{-6}}$$

4616

3983

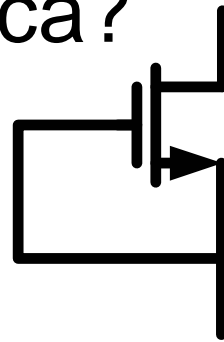
Miroir de courant CMOS

- Si la resistance etait 4616, V_{GS} serait
 - $5 - 4.616 = 0.384$ (en cut-off)
 - Si c'est en cutoff, I_D ne peut pas etre 1mA (contradiction)
- Si la resistance etait 3983, V_{GS} serait 1.017: c'est coherent



Miroir de courant CMOS

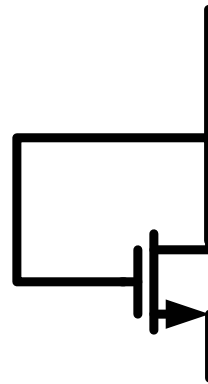
- Comment se rappeler des connexions?
- Est-ce que c'est ça?



- C'est quoi la valeur de V_{GS} ?
 - $V_G = V_S$ donc $V_{GS} < 0.7$ (cut off)
- Donc, ce n'est pas la bonne connexion

Miroir de courant CMOS

- La connexion est donc celle-ci

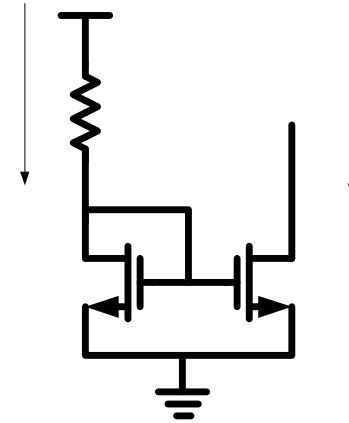


- $V_G = V_D$, donc on est toujours en saturation
- S'appelle la connexion "diode"
 - Plus petit que 0.7v (V_{TH}), c'est bloqué
 - Plus grand que 0.7v, ça conduit

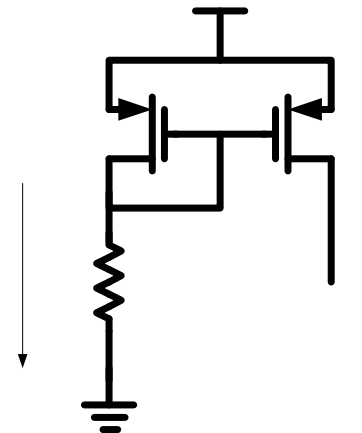
Miroir de courant CMOS

- Voici les equivalents:

“Tire” du courant



Fournit du courant

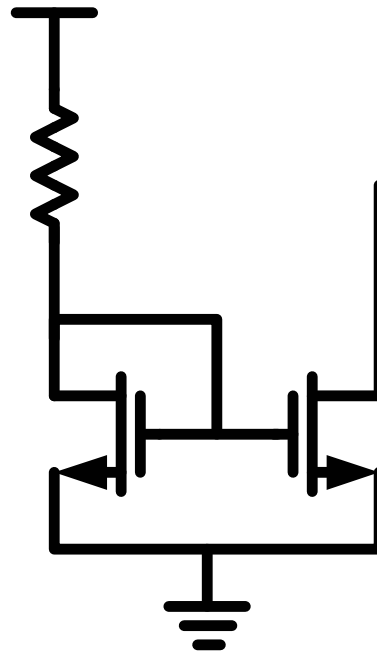


Miroir de courant CMOS

- Exemple (seul):
 - Je veux un miroir de courant qui tire 5mA
 - Les 2 transistors sont de meme taille
 - $\mu C_{OX}(W/L)=0.04$
 - $V_{DD}=5$
 - $V_{TH}=0.7$

Miroir de courant CMOS

- Ca “tire” ce courant, donc la structure est:



Miroir de courant CMOS

- On reprend notre equation:

$$0 = I_D^2 R^2 - I_D \left[2R(V_{DD} - V_{TH}) + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} \right)} \right] + (V_{DD} - V_{TH})^2$$

- On met les chiffres:

$$0 = 2.5 \times 10^{-5} R^2 - 5 \times 10^{-3} \left[2R(4.3) + \frac{1}{0.02} \right] + 18.49$$

- On met l'equation sous une forme connue

$$0 = 2.5 \times 10^{-5} R^2 - 0.043R + 18.24$$

Miroir de courant CMOS

- La solution est:

$$\frac{0.043 \pm \sqrt{0.043^2 - 4(2.5 \times 10^{-5})(18.24)}}{5 \times 10^{-5}}$$

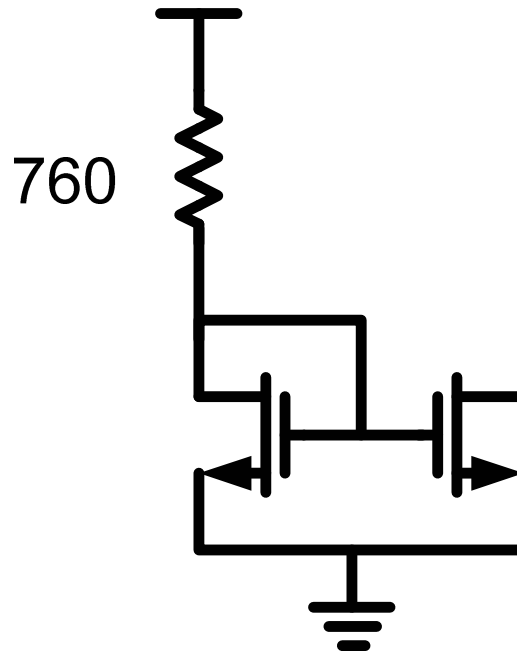
- Les 2 resistances sont

760

960

Miroir de courant CMOS

- Pour une resistance de 960, V_{GS} sera 0.2
 - Le transistor est en cutoff: contradiction
- Pour une resistance de 760, V_{GS} sera 1.2
 - On est correct.



Miroir de courant CMOS

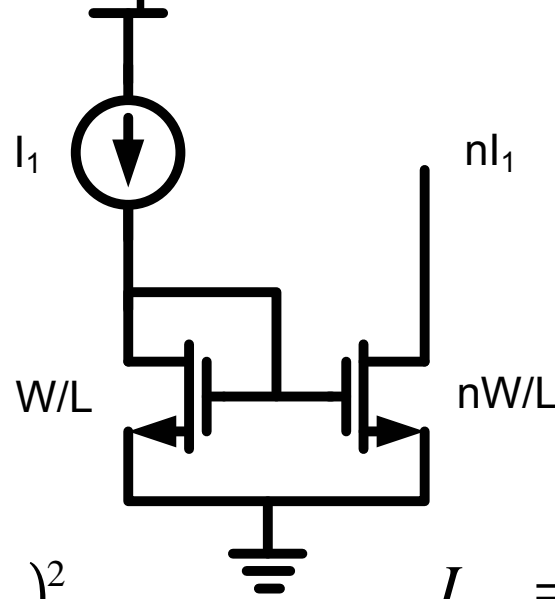
- Jusqu'à présent, on a considéré que les transistors étaient de même taille.
- Quand on conçoit, on peut avoir des transistors de tailles différentes
- Avec le RATIO des tailles, on peut ajuster le courant.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Avec même V_{GS} , le courant dépend de (W/L)

Miroir de courant CMOS

- Le ratio entre la taille des transistors nous donne une multiplication de courant



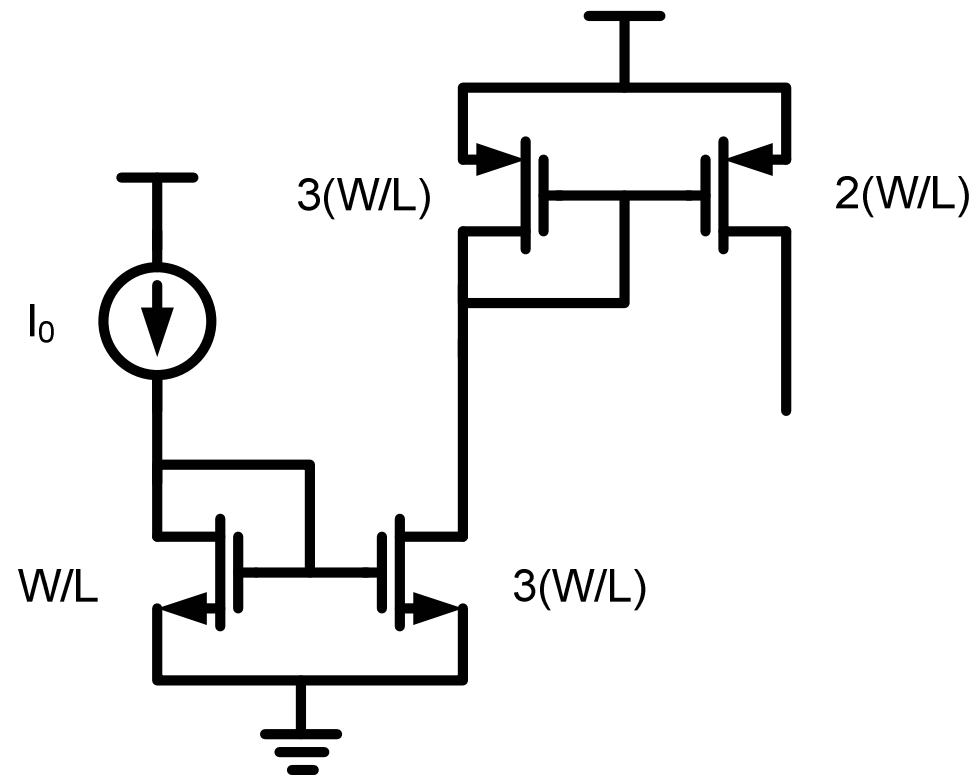
$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu C_{OX} \left(n \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$nI_{D1} = I_{D2}$$

Exemple (seul)

- Quel est le courant de sortie?
 - Hypothese (tout reste en saturation)



Exemple (seul)

- Premier miroir de courant: $3X I_0$
- Deuxieme miroir de courant: $2/3 I$

